

TAS2120 8.2W 具有集成式 14.75V H 类升压的单声道数字输入 D 类扬声器放大器

1 特性

- 强大的 D 类放大器
 - 8.2W 1% THD+N
 - 14.75V 升压和 5.1A 最大电流限制
- 出色的效率
 - 对于 8Ω 负载，在系统级别具有高达 90% 的效率
 - 12.9mW 空闲通道功率，噪声门关闭
 - 5mW 空闲通道功率，噪声门开启
 - 集成 1.8V Y 桥
- 高性能音频通道
 - 4.2μV A 加权空闲通道噪声
 - 114dB 动态范围
 - -89dB THD+N
 - 可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能
 - < 1μs 芯片间群延迟匹配
- 高级集成特性
 - 信号检测高效模式
 - 高精度电压监测器和温度传感器
 - 可编程电池电流限制，阶跃大小为 39mA
- 易于使用的特性
 - 硬件引脚控制或 I²C 控制
 - 1S 电池、2S 电池、外部 PVDD (3S 电池) 电源
 - 基于时钟的上电/断电
 - 自动时钟速率检测：16 至 192kHz
 - 无 MCLK 运行
 - 热保护和过流保护
- 电源和用户接口
 - VBAT：2.5V 至 5.5V
 - VDD：1.65V 至 1.95V
 - IOVDD：1.8V 或 3.3V
 - VBAT_SNS：2.5V 至 10.0V
 - I²S/TDM：8 通道
 - HW 引脚控制或基于 I²C 的控制
- 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装

2 应用

- 智能音箱 (带语音助理)
- 蓝牙和无线扬声器
- 平板电脑、可穿戴设备
- 笔记本电脑、台式电脑

3 说明

TAS2120 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器，具有集成升压，可在电池供电的系统中提供更高的功率。

器件经过优化，可以为音乐播放和语音通话的实际用例提供出色的电池续航表现。先进的效率优化功能 (如 Y 桥和算法) 使器件能够在工作的所有电源区域内提供出色的效率。该 D 类放大器能够使用集成的 H 类升压提供 8.2W 输出功率。

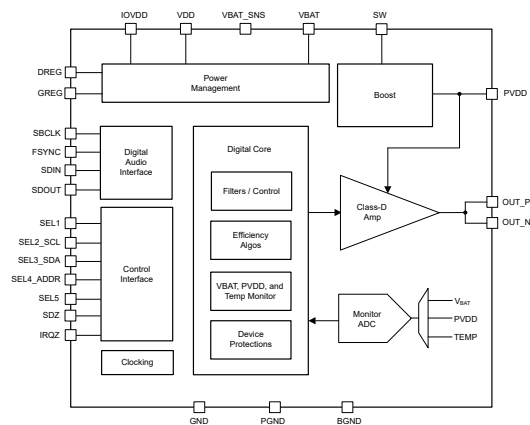
TAS2120 器件支持基于超前算法的最佳升压电压电平，以匹配音频信号的输出。这可以提供峰值输出所需的所有功率，同时可显著降低平均功耗。

最多四个器件可通过 I²S/TDM 和 I²C 接口共用公共总线。该器件还支持五个 HW 控制引脚，可用于将器件配置为所需的运行模式。

器件信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
TAS2120	QFN	4mm × 3.5mm

- 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
- 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



功能方框图



内容

1 特性	1	7 应用和实现	42
2 应用	1	7.1 应用信息.....	42
3 说明	1	7.2 典型应用.....	42
4 引脚配置和功能	2	8 电源相关建议	49
5 规格	4	9 布局	50
5.1 绝对最大额定值.....	4	9.1 布局指南.....	50
5.2 ESD 等级.....	4	9.2 布局示例.....	50
5.3 建议运行条件.....	4	10 器件和文档支持	51
5.4 热性能信息.....	5	10.1 文档支持.....	51
5.5 电气特性.....	5	10.2 接收文档更新通知.....	51
5.6 时序要求.....	13	10.3 支持资源.....	51
5.7 典型特性.....	14	10.4 商标.....	51
6 详细说明	17	10.5 静电放电警告.....	51
6.1 概述.....	17	10.6 术语表.....	52
6.2 功能方框图.....	17	11 修订历史记录	52
6.3 器件功能模式.....	17	12 机械、封装和可订购信息	52
6.4 特性说明.....	24	12.1 封装选项附录.....	53
6.5 编程.....	38	12.2 卷带包装信息.....	54

4 引脚配置和功能

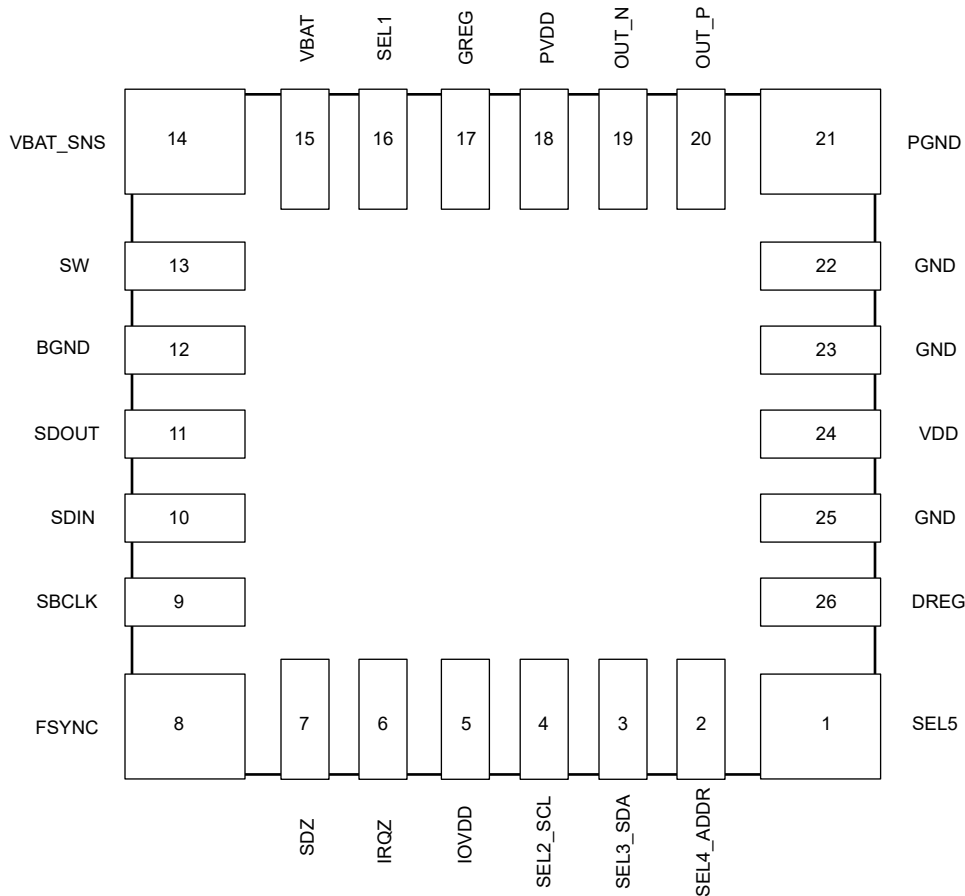


图 4-1. QFN 封装底视图

引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
BGND	12	P	升压地。通过多个过孔可靠连接到 PCB GND 平面。
DREG	26	P	数字内核稳压器输出。使用一个电容器旁路至 GND。不要连接至外部负载。
FSYNC	8	I	I ² S 字时钟或 TDM 帧同步。
GREG	17	P	高侧栅极 CP 稳压器输出。不要连接至外部负载。
GND	22、23、25	P	连接至 PCB GND 平面。需要通过多个过孔可靠连接到接地平面。
IOVDD	5	P	1.8V 或 3.3V 数字 IO 电源。使用电容器进行去耦 (连接至 GND) 。
IRQZ	6	O	开漏、低电平有效中断引脚。如果未使用可选内部上拉电阻, 则使用电阻器上拉至 IOVDD。
OUT_N	19	O	D 类负输出。
OUT_P	20	O	D 类正输出。
PGND	21	P	D 类功率级地。通过多个过孔可靠连接到 PCB GND 平面。
PVDD	18	P	集成升压输出和 D 类功率级电源。
SBCLK	9	I	I ² S/TDM 串行位时钟。
SDIN	10	I	I ² S 或 TDM 串行数据输入。
SDOUT	11	I/O	I ² S 或 TDM 串行数据输出。
SDZ	7	I	低电平有效硬件关断。
SEL1	16	I	HW 模式: 选择 1 引脚。通过音量斜坡启用和禁用选项选择放大器增益电平。 I ² C 模式: 短接至 GND 可以选择 I ² C 模式。
SEL2_SCL	4	I	HW 模式: 选择 2 引脚。I ² S、TDM、左平衡选择。 I ² C 模式: 时钟引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。
SEL3_SDA	3	I/O	HW 模式: 选择 3 引脚。数据有效上升沿和下降沿选择。 I ² C 模式: 数据引脚。使用电阻器上拉至 IOVDD。
SEL4_ADDR	2	I	HW 模式: 选择 4 引脚。Y 桥阈值配置设置。 I ² C 模式: I ² C 地址引脚。
SEL5	1	I/O	HW 模式: 选择 5 引脚。升压 1S、2S、外部 PVDD 模式选择。
SW	13	P	升压转换器开关输入。
VBAT	15	P	电池电源输入。连接至 2.5 至 5.5V 电源, 并使用电容器去耦。
VBAT_SNS	14	I	电池检测端子。连接至 1S 或 2S 电池电源以进行远程电池检测。如果未使用远程检测功能, 请将引脚接地。
VDD	24	P	连接至 1.8V 电源, 并使用电容器去耦至 GND。

(1) I = 输入, O = 输出, I/O = 输入或输出, G = 接地, P = 电源。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压	PVDD	-0.3	19	V
电源电压	VBAT	-0.3	6	V
电源电压检测	VBAT_SNS	-0.3	12	V
电源电压	VDD	-0.3	2	V
电源电压	IOVDD	-0.3	6	V
升压开关引脚	SW	-0.7	19	V
D 类输出	OUTP、OUTM	-0.7	19	V
高侧驱动稳压器	GREG	-0.3	PVDD + 6	V
数字电源稳压器	DREG	-0.3	1.65	V
数字 IO 引脚	以 IOVDD 电源为基准的数字引脚	-0.3	6	V
T _{stg}	贮存温度	-65	150	°C

(1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

5.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准, 所有引脚 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准, 所有引脚 ⁽²⁾	±500	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
V _{BAT}	电池电源 (1S 运行模式 - 默认)	2.5	3.6	5.5	V
	电池电源 (2S 运行模式)	3	3.6	5.5	V
V _{BAT_SNS}	电池检测引脚电压	2.5		10	V
V _{LOW_VBAT}	低压电池运行模式下的电池电压 (通过电感器连接到 SW 引脚)	1.8	3.6	5.5	V
V _{BAT2S}	2S 电池电压 (在 2S 运行模式下通过电感器连接到 SW 引脚)	4.7	7.2	10	V
V _{PVDD}	放大器电源 (外部 PVDD 模式)	V _{BAT}	12	15	V
V _{VDD}	电源电压	1.65	1.8	1.95	V
V _{IOVDD}	IO 电源电压 1.8V	1.62	1.8	1.98	V
V _{IOVDD}	IO 电源电压 3.3V	3.0	3.3	3.6	V
R _{SPK}	扬声器电阻	3.2	8	38.4	Ω
L _{SPK}	扬声器电感	5	33	100	μH
T _A	环境温度	-40		85	°C
T _J	结温	-40		150	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		标准 JEDEC ⁽²⁾		
		HR-QFN		
		26 引脚		
				单位
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	51.5		°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	28.5		°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	15.3		°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	0.9		°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	15.2		°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用		°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用报告。

(2) JEDEC 标准 4 层 PCB

5.5 电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{BAT} = 3.6\text{V}$, $V_{BAT2S} = 7.2\text{V}$ (启用 2S 模式), $PVDD = 12\text{V}$ (启用外部 PVDD 模式), $VDD = 1.8\text{V}$, $IOVDD = 1.8\text{V}$, $R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $LBOOST = 1\ \mu\text{H}$, $f_{in} = 1\ \text{kHz}$, $f_s = 48\ \text{kHz}$, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, $SDZ = 1$, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
放大器性能 - 15V 内部升压 1S 模式						
P_{OUT}	最大持续输出功率 - 1% THDN	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$		6.6		W
		$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $V_{BAT} = 4.4\text{V}$		8.2		W
		$R_L = 4\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$		6.6		W
		$R_L = 4\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $V_{BAT} = 4.4\text{V}$		8.2		W
P_{OUT}	最大持续输出功率 - 1% THDN	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, HW 引脚控制模式		6.6		W
		$R_L = 4\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, HW 引脚控制模式		6.6		W
P_{OUT}	最大持续输出功率 - 10% THDN	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $V_{BAT} = 4.4\text{V}$		9.5		W
		$R_L = 4\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $V_{BAT} = 4.4\text{V}$		9.5		W
$\eta_{SYSTEM_0.5W}$	$P_{OUT} = 0.5\text{W}$ 时的系统效率	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$		84.8		%
		$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $V_{BAT} = 4.4\text{V}$		88		%
η_{SYSTEM_1W}	$P_{OUT} = 1.0\text{W}$ 时的系统效率	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$		86.8		%
		$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $V_{BAT} = 4.4\text{V}$		87		%
η_{SYSTEM_1W}	$P_{OUT} = 1.0\text{W}$ 时的系统效率	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, HW 引脚控制模式		86.8		%
		$R_L = 4\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, HW 引脚控制模式		86.8		%
$\eta_{SYSTEM_MAX_POUT}$	1% THD+N 功率级别下的系统效率	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$		81.2		%
$\eta_{SYSTEM_MAX_POUT}$	1% THD+N 功率级别下的系统效率	$R_L = 8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, HW 引脚控制模式		73		%
		$R_L = 4\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, HW 引脚控制模式		77.4		%
V_N	空闲通道噪声	A 加权, 增益 = 6dBV (接收器模式), DAC 运行		4.2		μV
		A 加权, 增益 = 21dBV (扬声器模式), DAC 运行		14.4		μV

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8 Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DNR	动态范围	A 加权, -60dBFS 方法, RL = 8 Ω + 33μH, 增益 = 6dBV (接收器模式)		113.7		dB
		A 加权, -60dBFS 方法, RL = 8 Ω + 33μH, 增益 = 21dBV (扬声器模式)		117.2		dB
THD+N	总谐波失真 + 噪声	POUT = 1W, RL = 8 Ω + 33μH		0.01		%
		POUT = 1W, RL = 8 Ω + 33μH, fin = 6.6kHz		0.01		%
		POUT = 1W, RL = 4 Ω + 33μH		0.01		%
		POUT = 0.25W, RL = 8 Ω + 33μH, 增益 = 6dBV (接收器模式)		0.01		%
KCP	咔嗒声和砰砰声性能	音频通道的所有动态上电/断电, 故障除外。包括进入/退出静音、上电和断电、噪声门模式进入和退出。在峰值 A 加权电压下测得。RL = 8 Ω + 33μH, 输入 = 数字静音		-67		dBV
BW	放大器输入信号带宽	fs ≥ 96ksps, 增益误差 < 通带纹波		40		kHz
VFS	满标度等效电压	在 -6dBFS 输入下测得		11.22		VRMS
		在 -6dBFS 输入下测得, 增益 = 6dBV (接收器模式)		2.00		VRMS
AGAIN	音频通道增益可编程范围	阶跃为 0.5dB 的增益可编程性	0		21	dBV
AGAIN_ER	放大器增益误差	POUT = 1W		±0.1		dB
		POUT = 0.25W, 增益 = 6dBV (接收器模式)		±0.1		dB
VOS	输出失调电压	空闲通道	-1		1	mV
		空闲通道, 增益 = 6dBV (接收器模式)	-1		1	mV
FPWM	D 类 PWM 开关频率	平均时钟频率		384		kHz
PSRRVB AT	VBAT 电源抑制比	VBAT = 3.6V + 200mVpp, f_ripple = 217Hz		115		dB
		VBAT = 3.6V + 200mVpp, f_ripple = 1kHz		115		dB
		VBAT = 3.6V + 200mVpp, f_ripple = 20kHz		85		dB
PSRRVD D	VDD 电源抑制比	VDD = 1.8V + 200mVpp, f_ripple = 217Hz		110		dB
		VDD = 1.8V + 200mVpp, f_ripple = 1kHz		110		dB
		VDD = 1.8V + 200mVpp, f_ripple = 20kHz		85		dB
MUTE_A TTN	静音衰减	器件处于静音模式。DAC 调制器运行		110		dB
放大器性能 - 内部升压 2S 模式						
POUT_BO OST_2S	最大持续输出功率 - 10% THDN	RL = 8 Ω + 33μH		9.8		W
POUT_BO OST_2S	最大持续输出功率 - 10% THDN	RL = 8 Ω + 33μH, VBAT2S = 8.4V		10.5		W
η SYSTEM _0.5W_2S	POUT = 0.5W 时的系统效率	RL = 8 Ω + 33μH		87.0		%
		RL = 8 Ω + 33μH, VBAT2S = 8.4V		86.2		%
		RL = 4 Ω + 33μH		83.5		%
		RL = 4 Ω + 33μH, VBAT2S = 8.4V		82.7		%

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
η _{SYSTEM_1W_2S}	P _{OUT} = 1.0W 时的系统效率	RL = 8Ω + 33μH	89.9		%
		RL = 8Ω + 33μH, VBAT2S = 8.4V	89.5		%
		RL = 4Ω + 33μH	86.2		%
		RL = 4Ω + 33μH, VBAT2S = 8.4V	85.8		%
η _{SYSTEM_1W_2S}	P _{OUT} = 1.0W 时的系统效率	RL = 8Ω + 33μH, HW 引脚控制模式	89.9		%
		RL = 4Ω + 33μH, HW 引脚控制模式	89.9		%
η _{SYSTEM_MAX_POUT_2S}	1% THD+N 功率级别下的系统效率	RL = 8Ω + 33μH	85		%
		RL = 8Ω + 33μH, VBAT2S = 8.4V	86.5		%
		RL = 4Ω + 33μH	77.4		%
		RL = 4Ω + 33μH, VBAT2S = 8.4V	78.0		%
η _{SYSTEM_MAX_POUT_2S}	1% THD+N 功率级别下的系统效率	RL = 8Ω + 33μH, HW 引脚控制模式	85		%
		RL = 4Ω + 33μH, HW 引脚控制模式	78.5		%
VN_2S	空闲通道噪声	A 加权, 增益 = 6dBV (接收器模式), DAC 运行	7.0		μV
		A 加权, 增益 = 21dBV (扬声器模式), DAC 运行	14.4		μV
DNR_2S	动态范围	A 加权, -60dBFS 方法, 增益 = 6dBV (接收器模式)	108.9		dB
		A 加权, -60dBFS 方法, 增益 = 21dBV (扬声器模式)	114.4		dB
THD+N_2S	总谐波失真 + 噪声	P _{OUT} = 1W, RL = 8Ω + 33μH, fin = 1kHz	0.003		%
		P _{OUT} = 1W, RL = 4Ω + 33μH, fin = 1kHz	0.003		%
		P _{OUT} = 0.25W, RL = 8Ω + 33μH, fin = 1kHz, 增益 = 6dBV (接收器模式)	0.005		%
K _{CP_2S}	咔嗒声和砰砰声性能		-68		dBV
PSRR _{VB_AT2S}	VBAT2S 电源抑制比	VBAT2S = 7.2V + 200mV _{pp} , fripple = 217Hz	115		dB
		VBAT2S = 7.2V + 200mV _{pp} , fripple = 1kHz	115		dB
		VBAT2S = 7.2V + 200mV _{pp} , fripple = 20kHz	90		dB
PSRR _{VB_AT_2S}	VBAT 电源抑制比	VBAT = 3.6V + 200mV _{pp} , fripple = 217Hz	115		dB
		VBAT = 3.6V + 200mV _{pp} , fripple = 1kHz	115		dB
		VBAT = 3.6V + 200mV _{pp} , fripple = 20kHz	90		dB
PSRR _{VD_D_2S}	VDD 电源抑制比	VDD = 1.8V + 200mV _{pp} , fripple = 217Hz	110		dB
		VDD = 1.8V + 200mV _{pp} , fripple = 1kHz	110		dB
		VDD = 1.8V + 200mV _{pp} , fripple = 20kHz	90		dB
放大器性能 - 外部 PVDD 模式					

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8 Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
P _{OUT_EXT_PVDD}	最大持续输出功率 - 1% THDN	RL = 8 Ω + 33μH		8.3		W
		RL = 4 Ω + 33μH		14.9		W
P _{OUT_EXT_PVDD}	最大持续输出功率 - 1% THDN	RL = 8 Ω + 33μH, HW 引脚控制模式		8.3		W
P _{OUT_EXT_PVDD}	最大持续输出功率 - 10% THDN	RL = 8 Ω + 33μH		10.3		W
		RL = 4 Ω + 33μH		18.4		W
		RL = 4 Ω + 33μH, PVDD = 14V		24.5		W
η _{SYSTEM_EXT_0.5W}	P _{OUT} = 0.5W 时的系统效率	RL = 8 Ω + 33μH		83.9		%
		RL = 4 Ω + 33μH		80.0		%
η _{SYSTEM_EXT_1W}	P _{OUT} = 1.0W 时的系统效率	RL = 8 Ω + 33μH		88.1		%
		RL = 4 Ω + 33μH		84.2		%
η _{SYSTEM_EXT_1W}	P _{OUT} = 1.0W 时的系统效率	RL = 8 Ω + 33μH, HW 引脚控制模式		88.1		%
η _{SYSTEM_EXT_MAX_POUT}	1% THD+N 功率级别下的系统效率	RL = 8 Ω + 33μH		93.2		%
		RL = 4 Ω + 33μH		88.5		%
η _{SYSTEM_EXT_MAX_POUT}	1% THD+N 功率级别下的系统效率	RL = 8 Ω + 33μH, HW 引脚控制模式		93.2		%
V _{N_EXT}	空闲通道噪声	A 加权, 增益 = 21dBV (扬声器模式), DAC 运行		14.4		μV
DNR _{EXT}	动态范围	A 加权, -60dBFS 方法, RL = 8 Ω + 33μH		114.4		dB
THD+N _{EXT}	总谐波失真 + 噪声	P _{OUT} = 1W, RL = 8 Ω + 33μH, fin = 1kHz		0.003		%
		P _{OUT} = 1W, RL = 4 Ω + 33μH, fin = 1kHz		0.004		%
K _{CP_EXT}	咔嚓声和砰砰声性能	音频通道的所有动态上电/断电, 故障除外。包括进入/退出静音、上电和断电、噪声门模式进入和退出。在峰值 A 加权电压下测得。RL = 8 Ω + 33μH, 输入 = 数字静音		-68		dBV
V _{OS_EXT}	输出失调电压	空闲通道	-1		1	mV
PSRR _{PVDD_EXT}	PVDD 电源抑制比	PVDD = 12V + 200mV _{pp} , fripple = 217Hz		115		dB
		PVDD = 12V + 200mV _{pp} , fripple = 1kHz		115		dB
		PVDD = 12V + 200mV _{pp} , fripple = 20kHz		95		dB
PSRR _{VBAT_EXT}	VBAT 电源抑制比	VBAT = 3.6V + 200mV _{pp} , fripple = 217Hz		115		dB
		VBAT = 3.6V + 200mV _{pp} , fripple = 1kHz		115		dB
		VBAT = 3.6V + 200mV _{pp} , fripple = 20kHz		90		dB
PSRR _{VDD_EXT}	VDD 电源抑制比	VDD = 1.8V + 200mV _{pp} , fripple = 217Hz		110		dB
		VDD = 1.8V + 200mV _{pp} , fripple = 1kHz		110		dB
		VDD = 1.8V + 200mV _{pp} , fripple = 20kHz		90		dB
升压转换器						

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{BOOST_RANGE}	最大输出电压可编程范围	能够以 66mV 的阶跃编程,	5.5	14.75	V
V _{BOOST_S_TEP}	H 类输出电压阶跃大小		33		mV
V _{BOOST}	输出升压电压	I _O = 0.1A。平均输出值。 VBOOST_MAX_CTRL = 最大值	14.9		V
I _{BOOST_CL}	峰值输入电流限制	BST_ILIM = 最大设置	5.1		A
I _{BOOST_CL}	峰值输入电流限制	BST_ILIM = 最小设置	1.5		A
	峰值输入电流限制可编程阶跃大小		39.1		mA
升压转换器 2S 运行模式					
V _{BOOST_RANGE}	输出电压范围	能够以 66mV 的阶跃编程,	10	14.75	V
V _{BOOST_S_TEP}	H 类输出电压阶跃大小		33		mV
I _{BOOST_CL}	峰值输入电流限制	最大设置	5.1		A
I _{BOOST_CL}	峰值输入电流限制	最小设置	1.5		A
TDM 串行端口					
	PCM 采样率和 FSYNC 输入频率		16	192	kHz
	SBCLK 输入频率	I ² S/TDM 运行	0.512	24.57	MHz
	SBCLK 最大输入抖动	RMS 抖动低于 40kHz, 能够耐受而不会降低性能		0.5	ns
		RMS 抖动高于 40kHz, 能够耐受而不会降低性能		5	ns
	I ² S 和 TDM 模式下每个 FSYNC 的 SBCLK 周期数	值: 64、96、128、192、256、384 和 512	64	512	周期
fs ≤ 48kHz 时的 PCM 回放特征					
fs	采样率		16	48	kHz
	音频通道通带 LPF 转角频率	纹波 < 通带纹波		0.454	fs
	音频通道通带纹波	20Hz 至 LPF 截止频率		±0.1	dB
	音频通道阻带衰减	≥ 0.55 fs		60	dB
		≥ 1 fs		65	dB
	音频通道群延迟	Fin = 1kHz, H 类模式		31.5	1/fs
		Fin = 1kHz, 旁路 H 类		6.5	1/fs
		直流至 20kHz, 旁路 HPF, 旁路 H 类		11.0	1/fs
		直流至 20kHz, 旁路 HPF, H 类模式		37.0	1/fs
fs > 48kHz 时的 PCM 回放特征					
fs	采样率		88.2	192	kHz
	音频通道通带 LPF 转角频率	fs = 96kHz		0.469	fs
		fs = 192kHz		0.234	fs

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	音频通道通带纹波	20Hz 至 LPF 截止频率		±0.2		dB
	音频通道阻带衰减	fs = 96kHz, fin ≥ 0.55 fs		60		dB
		fs = 96kHz, fin ≥ 1 fs		65		dB
		fs = 192kHz, 0.55 fs ≥ fin ≥ 0.275 fs		60		dB
	音频通道群延迟	fin = 1kHz, fs = 96kHz, H 类模式		56.7		1/fs
		直流至 40kHz, fs = 96kHz, 旁路 HPF, 旁路 H 类		8.6		1/fs
		直流至 40kHz, fs = 192kHz, 旁路 HPF, H 类模式		117.8		1/fs
检测电路						
	温度测量范围		-40		150	°C
	温度测量分辨率			2		°C
	温度测量精度	在 25°C 时测得		±2.5		°C
	VBAT 测量范围	VBAT 引脚			6	V
		VBAT_SNS 引脚			12	V
	VBAT 测量分辨率	VBAT 引脚		1.25		mV
		VBAT_SNS 引脚		2.5		mV
	VBAT 测量精度	VBAT 引脚, 在 3.6V 下测得		±25		mV
		VBAT_SNS 引脚, 在 7.2V 下测得		±50		mV
	PVDD 测量范围				18	V
	PVDD 测量分辨率			3.75		mV
	PVDD 测量精度			±75		mV
保护电路						
	热关断温度			140		°C
	热关断重试时间			1.5		s
	VBAT 欠压锁定阈值 (UVLO)	UVLO 被置位	1.9			V
		UVLO 被释放			2.3	V
	VDD 欠压锁定阈值 (UVLO)	UVLO 被置位	1.4			V
		UVLO 被释放			1.6	V
	PVDD 欠压锁定阈值 (UVLO)	UVLO 被置为有效, 仅在外部 PVDD 模式下	2.6			V
		UVLO 被释放, 仅限外部 PVDD 模式			2.8	V
	PVDD 过压锁定阈值 (OVLO)	OVLO 被置为有效, OVLO 保护被启用。		16		V
	输出短路保护	输出到输出、输出到 GND、输出到 PVDD、输出到 VBAT, H 桥模式		4.1		A
上电/断电时间						
T _{STDBY}	从 SDZ 被置为有效到器件为 i2c 命令做好准备的开通时间				300	us
T _{ACTIVE}	从释放软件关断到放大器输出有效的开通时间	禁用音量斜坡		1.6		ms
		启用音量斜坡		3.9		ms

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
T_TURNOFF	从软件关断被置为有效到放大器输出高阻态的关断时间	禁用音量斜坡		0.2		ms
		启用音量斜坡		13.9		ms
电流消耗 - 内部升压模式						
I_Q_HW_SD	硬件关断时的电流消耗	VBAT, SDZ = 0		0.1		μA
		VDD, SDZ = 0		0.2		μA
		IOVDD, SDZ = 0		0.1		μA
I_Q_SW_SD	软件关断时的电流消耗	VBAT, 所有时钟均停止		0.1		μA
		VDD, 所有时钟均停止		12		μA
		IOVDD, 所有时钟均停止		0.1		μA
I_Q_NG	空闲通道中的电流消耗	VBAT, P_OUT = 0, 启用噪声门		0.19		mA
		VDD, P_OUT = 0, 启用噪声门		2.3		mA
		IOVDD, P_OUT = 0, 启用噪声门		0.1		mA
		总功率, P_OUT = 0, 启用噪声门		4.8		mW
I_Q_IDLE	空闲通道中的电流消耗	VBAT, P_OUT = 0, 禁用噪声门		0.62		mA
		VDD, P_OUT = 0, 禁用噪声门		5.7		mA
		IOVDD, P_OUT = 0, 禁用噪声门		0.1		mA
		总功率, P_OUT = 0, 禁用噪声门		12.5		mW
电流消耗 - 内部升压模式 2S 模式						
I_Q_HW_SD	硬件关断时的电流消耗	VBAT, SDZ = 0		0.1		μA
		VBAT2S, SDZ=0		0.1		μA
		VDD, SDZ = 0		0.2		μA
		IOVDD, SDZ = 0		0.1		μA
I_Q_SW_SD	软件关断时的电流消耗	VBAT, 所有时钟均停止		0.1		μA
		VBAT2S, 所有时钟均停止		0.1		μA
		VDD, 所有时钟均停止		12		μA
		IOVDD, 所有时钟均停止		0.1		μA
I_Q_NG	空闲通道中的电流消耗	VBAT, P_OUT = 0, 启用噪声门		0.2		mA
		VBAT2S, P_OUT = 0, 启用噪声门		0.1		mA
		VDD, P_OUT = 0, 启用噪声门		2.3		mA
		IOVDD, P_OUT = 0, 启用噪声门		0.1		mA
		总功率, P_OUT = 0, 启用噪声门		5.1		mW
I_Q_IDLE	空闲通道中的电流消耗	VBAT, P_OUT = 0, 禁用噪声门		0.5		mA
		VBAT2S, P_OUT = 0, 禁用噪声门		0.35		mA
		VDD, P_OUT = 0, 禁用噪声门		5.9		mA
		IOVDD, P_OUT = 0, 禁用噪声门		0.1		mA
		总功率, P_OUT = 0, 禁用噪声门		14.9		mW

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{Q_IDLE}	空闲通道中的电流消耗, HW 引脚控制模式	VBAT, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		VBAT2S, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		VDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		IOVDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		总功率, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mW
电流消耗 - 外部 PVDD 模式					
I _{Q_HW_SD}	硬件关断时的电流消耗	PVDD, SDZ = 0		1	μA
		VBAT, SDZ = 0		0.1	μA
		VDD, SDZ = 0		0.2	μA
		IOVDD, SDZ = 0		0.1	μA
I _{Q_SW_SD}	软件关断时的电流消耗	PVDD, 所有时钟均停止		1	μA
		VBAT, 所有时钟均停止		0.1	μA
		VDD, 所有时钟均停止		12	μA
		IOVDD, 所有时钟均停止		0.1	μA
I _{Q_NG}	空闲通道中的电流消耗	PVDD, P _{OUT} = 0, 启用噪声门		0.1	mA
		VBAT, P _{OUT} = 0, 启用噪声门		0.15	mA
		VDD, P _{OUT} = 0, 启用噪声门		2.2	mA
		IOVDD, P _{OUT} = 0, 启用噪声门		0.1	mA
		总功率, P _{OUT} = 0, 启用噪声门		5.3	mW
I _{Q_IDLE}	空闲通道中的电流消耗	PVDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门		0.2	mA
		VBAT, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门		0.5	mA
		VDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门		5.6	mA
		IOVDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门		0.1	mA
		总功率, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门		14.0	mW
I _{Q_IDLE}	空闲通道中的电流消耗, HW 引脚控制模式	PVDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		VBAT, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		VDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		IOVDD, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mA
		总功率, P _{OUT} = 0, 禁用噪声门			mW
数字 IO					
V _{IH}	高电平数字输入逻辑电压阈值	所有数字引脚	0.7 x IOVDD		V
V _{IL}	低电平数字输入逻辑电压阈值	所有数字引脚		0.3 x IOVDD	V
V _{OH}	高电平数字输出电压	所有数字引脚 (SDA、SCL 和 IRQZ 除外); I _{OH} = 100μA	IOVDD - 0.2V		V
V _{OL}	低电平数字输出电压	所有数字引脚 (SDA、SCL 和 IRQZ 除外); I _{OL} = -100μA		0.2	V
V _{OL(I2C)}	低电平数字输出电压	SDA 和 SCL; I _{OL} = -1mA		0.2 x IOVDD	V
V _{OL(IRQZ)}	开漏输出的低电平数字输出电压	IRQZ 引脚, I _{OL} = -1mA		0.2	V

5.5 电气特性 (续)

TA = 25°C, VBAT = 3.6V, VBAT2S = 7.2V (启用 2S 模式), PVDD = 12V (启用外部 PVDD 模式), VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, RL = 8Ω + 33μH, LBOOST = 1μH, fin = 1kHz, fs = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM (1S 电池) = 5.1A, BST_ILIM (2S 电池, HW 模式) = 4.1A, BST_ILIM (2S 电池, I2C 模式) = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{IH}	数字输入的输入逻辑高电平漏电流	-1		1	μA
I _{IL}	数字输入的输入逻辑低电平漏电流	-1		1	μA
C _{IN}	数字输入的输入电容		5		pF
R _{PD}	被置为有效时数字输入/IO 引脚的下拉电阻		18		kΩ

5.6 时序要求

T_A = 25°C, VDD = IOVDD = 1.8V (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
I2C - 标准模式					
f _{SCL}	SCL 时钟频率	0		100	kHz
t _{HD;STA}	(重复) START 条件后的保持时间。在此时间段之后, 生成第一个时钟脉冲。	4			μs
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	4.7			μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	4			μs
t _{SU;STA}	重复 START 条件的建立时间	4.7			μs
t _{HD;DAT}	数据保持时间: 对于 I ² C 总线器件	0		3.45	μs
t _{SU;DAT}	数据建立时间	250			ns
t _r	SDA 和 SCL 上升时间			1000	ns
t _f	SDA 和 SCL 下降时间			300	ns
t _{SU;STO}	STOP 条件的建立时间	4			μs
t _{BUF}	STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间	4.7			μs
C _b	每个总线的容性负载			400	pF
I2C - 快速模式					
f _{SCL}	SCL 时钟频率	0		400	kHz
t _{HD;STA}	(重复) START 条件后的保持时间。在此时间段之后, 生成第一个时钟脉冲。	0.6			μs
t _{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	1.3			μs
t _{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	0.6			μs
t _{SU;STA}	重复 START 条件的建立时间	0.6			μs
t _{HD;DAT}	数据保持时间: 对于 I ² C 总线器件	0		0.9	μs
t _{SU;DAT}	数据建立时间	100			ns
t _r	SDA 和 SCL 上升时间	20 + 0.1 × C _b		300	ns
t _f	SDA 和 SCL 下降时间	20 + 0.1 × C _b		300	ns
t _{SU;STO}	STOP 条件的建立时间	0.6			μs
t _{BUF}	STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间	1.3			μs
C _b	每个总线的容性负载			400	pF
I2C - 快速+ 模式					
TDM 端口					

5.6 时序要求 (续)

 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = IOVDD = 1.8\text{V}$ (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
$t_H(\text{SBCLK})$	SBCLK 高电平周期	20			ns
$t_L(\text{SBCLK})$	SBCLK 低电平时间	20			ns
$t_{\text{SU}}(\text{FSYNC})$	FSYNC 设置时间	8			ns
$t_{\text{HLD}}(\text{FSYNC})$	FSYNC 保持时间	8			ns
$t_{\text{SU}}(\text{SDIN/ICC})$	SDIN/ICC 建立时间	8			ns
$t_{\text{HLD}}(\text{SDIN/ICC})$	SDIN/ICC 保持时间	8			ns
$t_d(\text{SDO/ICC-SBCLK})$	SBCLK 到 SDOOUT/ICC 延迟: SBCLK 的 50% 至 SDOOUT 的 50%, $IOVDD = 1.8\text{V}$			13	ns
$t_d(\text{SDO/ICC-SBCLK})$	SBCLK 到 SDOOUT/ICC 延迟: SBCLK 的 50% 至 SDOOUT 的 50%, $IOVDD = 3.3\text{V}$			30	ns
$t_r(\text{SBCLK})$	SBCLK 上升时间: 10% - 90% 上升时间			8	ns
$t_f(\text{SBCLK})$	SBCLK 下降时间: 90% - 10% 上升时间			8	ns

5.7 典型特性

除非另有说明, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{BAT} = 3.6\text{V}$, $V_{BAT2S} = 7.2\text{V}$ (启用 2S 模式), $PVDD = 12\text{V}$ (启用外部 PVDD 模式), $V_{DD} = 1.8\text{V}$, $IOVDD = 1.8\text{V}$, 负载 = $8\ \Omega + 33\ \mu\text{H}$, $L_{BOOST} = 1\ \mu\text{H}$, $F_{IN} = 1\text{kHz}$, $F_s = 48\text{kHz}$, 增益 = 21dBV , BST_ILIM (1S 升压模式) = 5.1A , BST_ILIM (2S 升压模式) = 4.1A , $SDZ = 1$, 禁用噪声门模式, 测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得。

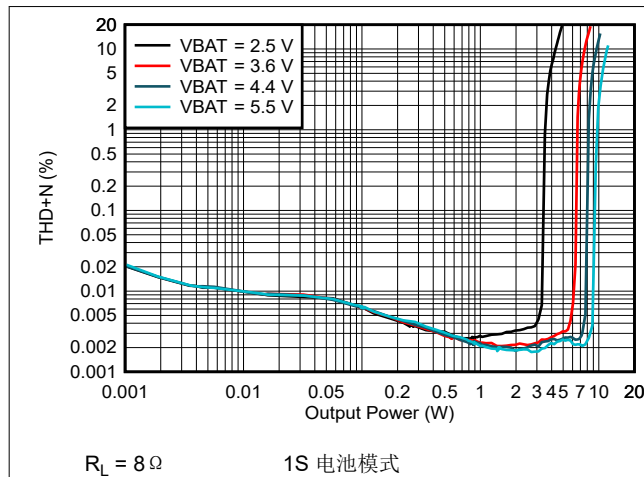


图 5-1. THD+N 与输出功率间的关系

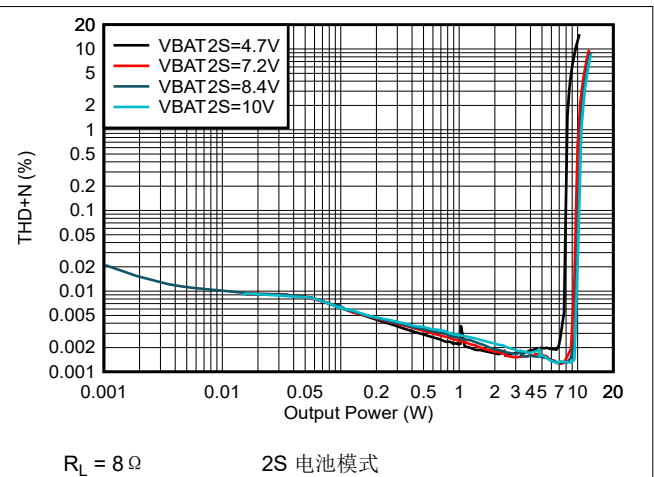
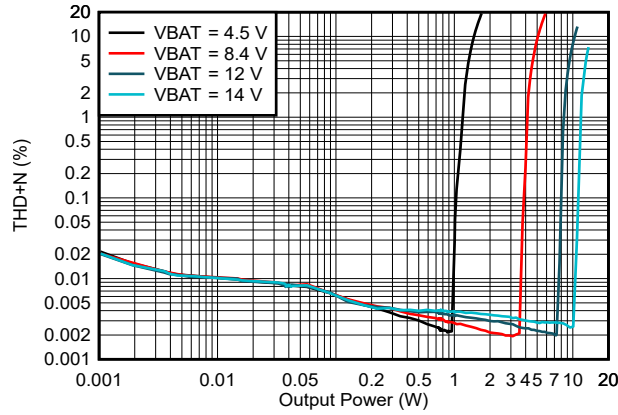
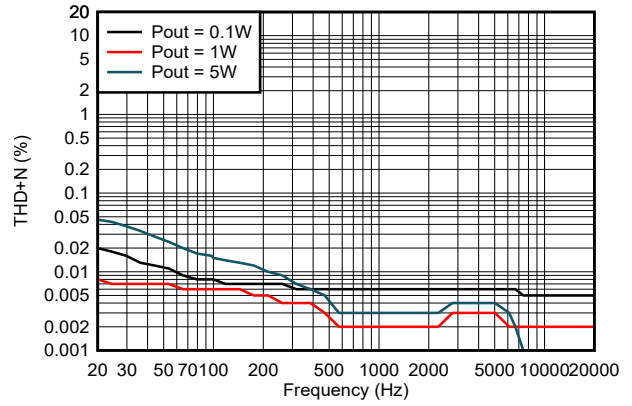


图 5-2. THD+N 与输出功率间的关系



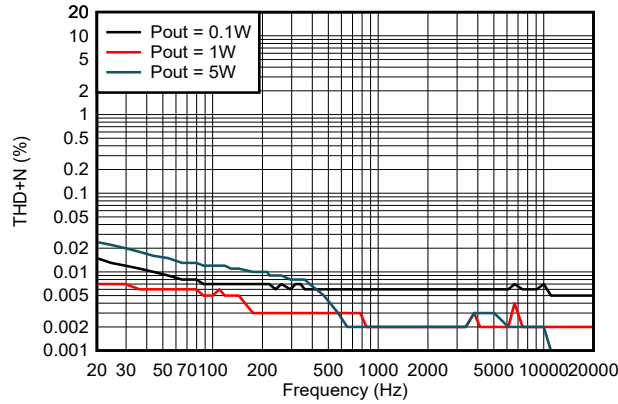
$R_L = 8\ \Omega$ 外部 PVDD 模式

图 5-3. THD+N 与输出功率间的关系



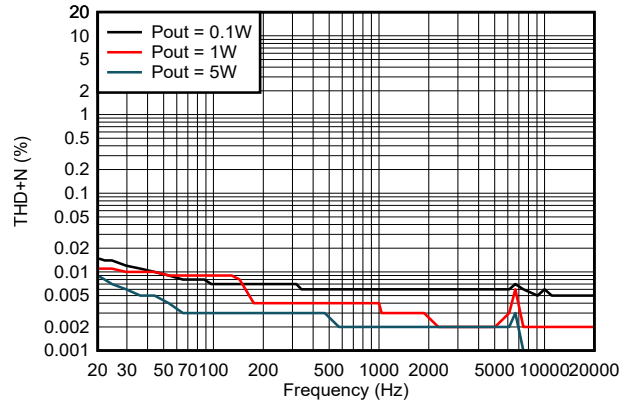
$R_L = 8\ \Omega$ VBAT = 3.6V 1S 电池模式

图 5-4. THD+N 与频率间的关系



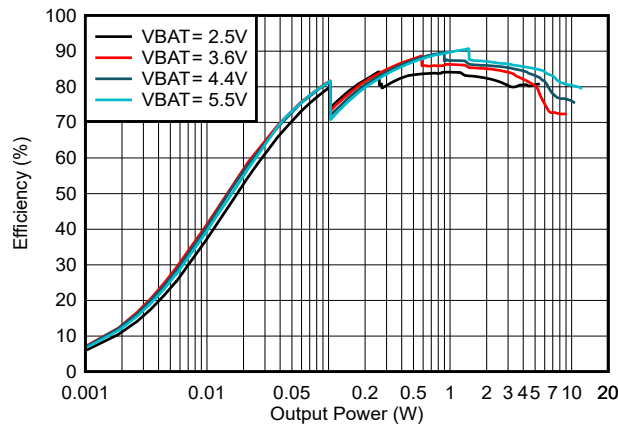
$R_L = 8\ \Omega$ VBAT2S = 7.2V 2S 电池模式

图 5-5. THD+N 与频率间的关系



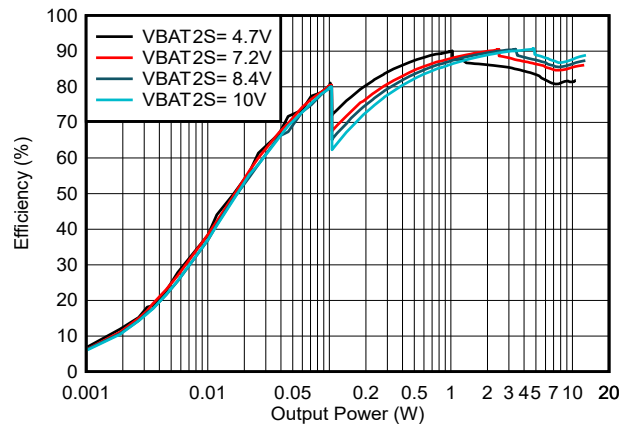
$R_L = 8\ \Omega$ PVDD = 12V 外部 PVDD 模式

图 5-6. THD+N 与频率间的关系



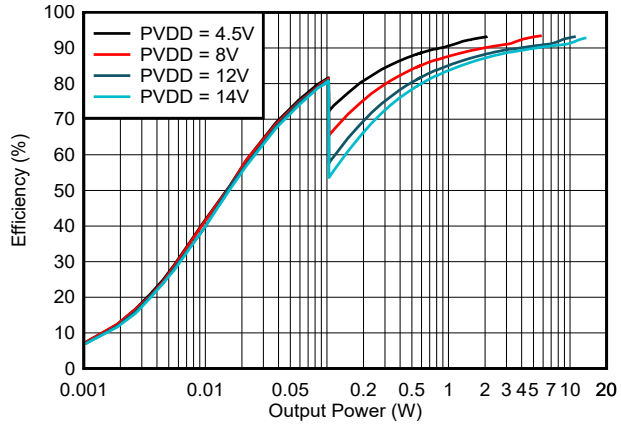
$R_L = 8\ \Omega$ 1S 电池模式

图 5-7. 效率与输出功率间的关系



$R_L = 8\ \Omega$ 2S 电池模式

图 5-8. 效率与输出功率间的关系



$R_L = 8\ \Omega$

外部 PVDD 模式

图 5-9. 效率与输出功率间的关系

6 详细说明

6.1 概述

TAS2120 是一款单声道数字输入 D 类放大器，经优化可在所有电源上提供超高效率，从而延长电池寿命。该器件具有小解决方案尺寸，适用于布板空间受限的应用。它集成了阶跃大小分辨率为 33mV、用于 H 类控制的 H 类升压、高精度扬声器电压和电流传感器以及电池/温度传感器，可提供系统级保护功能。

6.2 功能方框图

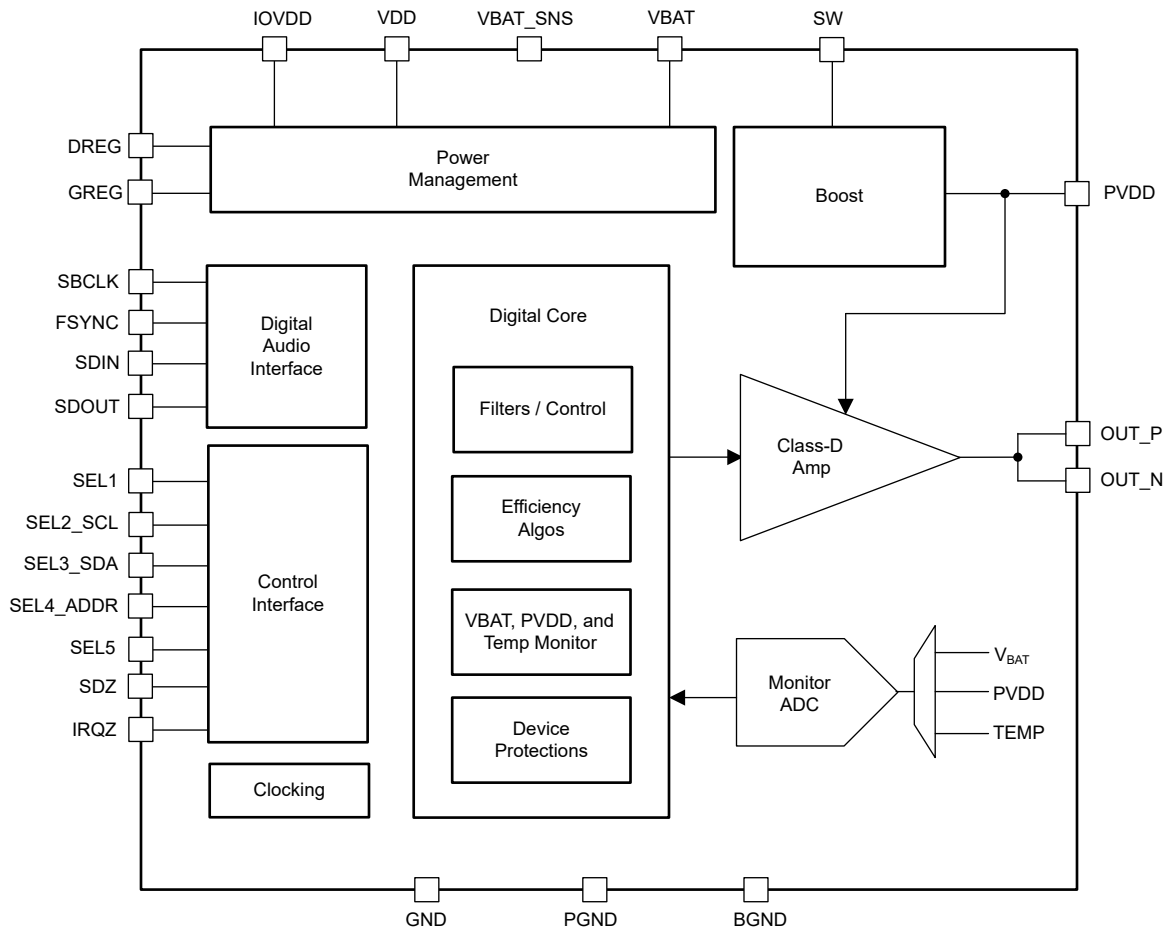


图 6-1. 简要功能方框图

6.3 器件功能模式

6.3.1 工作模式

6.3.1.1 硬件关断

可以通过将 SDZ 引脚置为低电平来关断器件。SDZ 引脚被拉至低电平时，器件关断，该行为由 SDZ_MODE 寄存器设置控制。

在硬件关断模式下 (SDZ_MODE[1:0] = 00 或 01)，如果 SDZ 引脚被置为低电平，则器件会消耗来自 VDD 和 VBAT 电源的最小静态电流。在该模式下所有寄存器会丢失状态并恢复默认设置，同时禁用 I²C 通信。

如果配置为 $SDZ_MODE[1:0] = 00$ ，则当 SDZ 引脚在音频播放过程中被置为低电平时，器件将遵循正常的断电时序，例如音频音量斜降（如果启用），停止 D 类开关，为模拟和数字块断电以确保没有断电砰砰声，并最终将器件置于硬件关断模式。在该模式下， SDZ 引脚被置为低电平时会禁用 I2C 通信。

如果配置为 $SDZ_MODE[1:0] = 01$ ，则当 SDZ 引脚被置为低电平时，器件将立即进入硬件关断状态，而不会执行任何断电时序例程。建议确保在该模式下将 SDZ 引脚置为低电平之前，将音频输入信号斜降至空闲通道（可以使用器件软件静音模式来实现这一点）。在该模式下， SDZ 引脚被置为低电平时会禁用 I2C 通信。

最后，可以通过设置 $SDZ_MODE[1:0] = 10$ 将器件配置为软件关断模式。在该模式下，当 SDZ 引脚被拉至低电平时，器件将遵循正常的断电时序并进入软件关断模式。编程的所有器件寄存器配置均按照器件在 SDZ 引脚被拉至低电平之前所处的状态进行保留。在该模式下， SDZ 引脚被置为低电平时 I2C 通信仍然可用。

表 6-1. 关断控制

SDZ_MODE[1:0]	配置
00 (默认值)	具有断电时序的硬件关断模式
01	硬件关断模式 - 立即
10	软件关断模式 (保留所有寄存器值)
11	保留

当 $SDZ_MODE[1:0]$ 为 00 或 10 时，器件会执行关断时序， SDZ 引脚必须在整个关断时间内保持低电平。关断时间在“电气特性”部分的“上电/断电时间”部分中指定。释放 SDZ 引脚时，器件会对 AD1 和 AD2 引脚进行采样并进入软件关断模式。

6.3.1.2 硬件配置模式

根据用于选择引脚 1 至选择引脚 5 的端接，器件可以在预配置的 HW 模式下运行。器件的 HW 模式行为旨在简化器件配置，而无需通过 I²C 通信使用任何基于软件的配置。

表 6-2. SEL1 HW 模式配置

SEL1 连接	配置
直接短接至 GND	I ² C 模式选择
1.2k 至 GND	6dBV 放大器增益，禁用音量斜坡
1.2k 至电源	12dBV 放大器增益，禁用音量斜坡
5k 至 GND	18dBV 放大器增益，禁用音量斜坡
330 至电源	21dBV 放大器增益，禁用音量斜坡
4.7k 至电源	6dBV 放大器增益，启用音量斜坡
24k 至 GND	12dBV 放大器增益，启用音量斜坡
24k 至电源	18dBV 放大器增益，启用音量斜坡
直接短接至电源	21dBV 放大器增益，启用音量斜坡

表 6-3. SEL2 HW 模式配置

SEL2_SCL 连接	配置
直接短接至 GND	I ² S L 或 TDM0
470 至电源	I ² S R 或 TDM1
直接短接至电源	I ² S (L+R)/2 或 TDM2

表 6-3. SEL2 HW 模式配置 (续)

SEL2_SCL 连接	配置
1.2k 至 GND	左对齐 L 或 TDM3
1.2k 至电源	左对齐 R 或 TDM4
4.7k 至 GND	左对齐 (L+R)/2 或 TDM5
4.7k 至电源	I ² S L+Tx 或 TDM6
24k 至 GND	I ² S R+Tx 或 TDM7
24K 至电源	保留

表 6-4. SEL3 HW 模式配置

SEL3_SDA 连接	配置
直接短接至 GND	数据在上升沿有效
直接短接至电源	数据在下降沿有效

表 6-5. SEL4 HW 模式配置

SEL4_ADDR 连接	配置
直接短接至 GND	80mW 的 Y 桥阈值
直接短接至电源	40mW 的 Y 桥阈值
24K 至电源	1mW 的 Y 桥阈值

表 6-6. SEL5 HW 模式配置

SEL5_CLASSH 连接	配置
直接短接至 GND	1S 电池模式, 升压开启
直接短接至电源	外部 PVDD (3S 电池) 模式
24K 至电源	2S 电池模式, 升压开启

6.3.1.3 软件电源模式控制和软件复位

可以使用寄存器 `MODE[1:0]` 来控制 TAS2120 电源状态。任何 `MODE` 设置的更改都不会导致器件丢失任何现有器件配置寄存器设置。

工作状态：当 `MODE[1:0]` 配置为“00”时，器件进入工作运行模式，采用适当的上电时序，从而尽可能地减少咔嗒声和砰砰声。

软件关断状态：当 `MODE[1:0]` 配置为“10”时，器件进入软件关断模式。该模式会将回放音频所需的所有模拟块断电，但不会导致器件丢失寄存器状态。如果在软件关断有效时正在播放音频，则 D 类音频放大器将在关断前缓慢降低音量。当软件关断被置为无效后，D 类音频放大器开始恢复，音量将缓慢升回所设定的数字音量值。

基于时钟的工作和关断状态：当 `MODE[1:0]` 配置为“11”时，器件会根据应用于 ASI 输入引脚 `BCLK` 和 `FSYNC` 上的有效 ASI 时钟信号在工作与关断状态之间切换。应用时钟时，器件将自动检测时钟信号，并遵循正确的上电时序，以避免任何上电咔嗒声和砰砰声。当音频通道上电且 ASI 时钟被移除时，器件将自动启动断电时序并避免出现任何咔嗒声和砰砰声。建议在停止时钟之前在输入数据流中降低音量，以实现最佳咔嗒声和砰砰声体验（可以使用器件软件静音模式来实现这一点）。

表 6-7. 软件模式控制

MODE[1:0]	配置
00	器件处于工作运行模式
01	保留
10 (默认值)	器件处于软件关断模式

表 6-7. 软件模式控制 (续)

MODE[1:0]	配置
11	器件处于基于时钟的工作和关断模式

通过将 SW_RESET 寄存器设置为“1”，可以将 TAS2120 复位至默认配置。如果器件上电，则当 SW_RESET 位被设置为高电平时，所有通道都会立即断电。当 SW_RESET 被设置为高电平时，所有寄存器都会恢复为默认状态。该位会自清零，在复位完成后返回到“0”。

一旦器件状态达到工作运行模式，器件还可以使用 INT_LTCH0[1] 位 (节 6.3.2) 向主机发送信号。该位是实时器件状态位，实时反映器件状态。当器件处于工作模式时，该位被设置为高电平；当器件处于关断模式时，该位被设置为低电平。

6.3.1.4 高效和节能模式

TAS2120 具有多种节能运行模式，可在所有工作条件下实现超高系统级效率。器件会根据配置的模式和信号条件，从一种模式转换到另一种模式。器件会自动从一种模式切换到另一种模式，旨在确保在模式切换期间提供高性能音频电平。

EFFICIENCY_MODE[1:0] 寄存器允许配置音乐效率和噪声门运行模式

6.3.1.4.1 噪声门

启用噪声门功能后，器件会在有效回放模式下自动检测静音周期，并显著降低空闲通道的功耗，从而延长电池寿命。该功能对于长时间静音的信号播放 (例如语音呼叫、电影原声等) 非常有用。

器件根据由 NG_TH_LVL[2:0] 寄存器配置的编程噪声门阈值监测输入音频信号电平。当音频信号降至阈值以下时，会启用内部迟滞计时器。如果信号电平在 NG_HYST_TIMER[1:0] 整个持续时间内保持低于配置的 NG_TH_LVL[2:0]，则器件进入噪声门模式并降低空闲通道功耗。在噪声门运行模式下，D 类 PWM 输出等高开关块将关断，并将输出拉至低电平。当噪声门模式有效时，可以使用 CLASSD_HIZ_MODE 寄存器来控制 D 类的输出阻抗。当噪声门模式有效时，D 类输出不进行开关，器件不会产生任何音频输出信号。当器件处于噪声门模式时，NG_STATUS 位设置被为高电平，而当器件退出噪声门模式时，状态位被设置为低电平。

当信号电平增加到高于 NG_TH_LVL[1:0] 时，器件会在低 IQ 模式下自动唤醒块并开始播放音频输入信号。从噪声门唤醒可在从噪声门模式到有效回放模式的转换期间通过缓冲输入信号数据来保持信号保真度。器件在从噪声门转换到有效回放时不会丢失任何音频输入样本。

通过遵循正确的关断和上电时序，可以在转换到噪声门模式和从噪声门模式恢复时无咔嗒声和砰砰声。

表 6-8. 噪声门阈值

NG_TH_LVL[2:0]	配置
000	-85dBFS
001	-90dBFS
010	-95dBFS
011	-100dBFS
100 (默认值)	-105dBFS
101	-110dBFS
110	-115dBFS
111	-120dBFS

表 6-9. 噪声门迟滞计时器

NG_HYST_TIMER[1:0]	配置
00	10ms
01 (默认值)	50ms
10	100ms
11	1000ms

6.3.1.4.2 音乐效率模式

启用音乐效率模式功能后，器件会在有效回放模式期间自动检测低功耗信号状态并降低整体 I_Q 功耗，从而延长电池寿命。此功能对于具有不同信号电平的动态音频信号（例如音乐曲目、语音呼叫、电影原声等）非常有用。

器件根据由 `MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0]` 寄存器配置的编程音乐效率阈值监测输入音频信号电平。当音频信号降至阈值以下时，会启用内部迟滞计时器。如果信号电平在 `MUSIC_EFF_MODE_TIMER[23:0]` 的整个持续时间内保持低于配置的 `MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0]`，则器件进入音乐效率模式。当器件处于音乐效率模式时，`MUSIC_EFF_STATUS` 位被设置为高电平，而当器件退出音乐效率模式时，状态位被设置为低电平。

当信号电平增加到高于 `MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0]` 时，器件会在低 I_Q 模式下自动唤醒块并继续播放音频输入信号。从音乐效率模式到正常操作的转换仅会产生极少的咔嗒声和砰砰声。当器件处于音乐效率模式时，音频通道性能保持不变，不会影响输出信号电平和噪声。

可以使用 PPC3 软件配置 `MUSIC_EFF_MODE_THR[23:0]` 和 `MUSIC_EFF_MODE_TIMER[23:0]` 寄存器，请参阅节 6.4.1。

6.3.1.4.3 VDD Y 桥

TAS2120 使用 Y 桥输出级在 VDD 和 PVDD 电源之间切换 D 类输出 PWM 电压。通过将 `EN_Y_BRIDGE_MODE` 设置为高电平启用该功能后，器件将自动选择输出电压以切换输出 PWM。当信号为低电平时，输出将切换到 VDD，从而通过降低 D 类输出开关电压来实现更高的系统级效率。当信号为高电平时，输出将开启由集成升压设置的 PVDD 电压轨，或外部 PVDD 运行模式下的外部 PVDD 电压轨。

该器件根据由 `VDD_MODE_THR_LVL[23:0]` 寄存器配置的编程 Y 桥模式阈值监测输入音频信号电平。当音频信号降至阈值以下时，会启用内部迟滞计时器。如果信号电平在所选的整个持续时间内保持低于配置的 `YBRIDGE_HYST_TIMER[1:0]`，则器件将进入基于低电压 VDD 电源的 PWM 开关模式。

当信号电平增加到 `VDD_MODE_THR_LVL[23:0]` 加 `VDD_MODE_HYST[23:0]` 以上时，器件开始开关 PVDD 电源上的输出 PWM 信号，而不会引入任何信号削波。

可以使用 PPC3 软件配置 `VDD_MODE_THR_LVL[23:0]` 和 `VDD_MODE_HYST[23:0]` 寄存器，请参阅节 6.4.1。

表 6-10. VDD Y 桥迟滞计时器

YBRIDGE_HYST_TIMER[1:0]	配置
00	100us
01 (默认值)	500us
10	5ms
11	50ms

表 6-11. VDD Y 桥启用

EN_Y_BRIDGE_MODE	配置
0	禁用 Y 桥模式
1 (默认值)	启用 Y 桥模式

6.3.1.4.4 H 类升压

TAS2120 具有先进的 H 类算法，可控制集成式升压。H 类算法使得升压电源能够紧密跟踪音频信号电平，并实现高系统级效率，从而延长电池寿命。可以使用 `BST_MODE[1:0]` 寄存器启用 H 类模式。

H 类算法会缓冲输入信号，从而实现为升压输出电容器充电并避免任何信号削波所需的足够超前时间。该算法可监测输入信号电平并使用 PPC3 软件中配置的系统级参数（例如升压输出电压、升压输出电容器、通道增益等），还可以计算最佳 H 类调优参数。然后，在 PPC3 软件中计算这些调优参数寄存器，并在相应的 `CLASSH_TUNING_x[23:0]` 寄存器中进行配置。

当 `BST_MODE[1:0]` 配置为在 G 类模式或升压常开模式下使用器件时，可以通过在 PPC3 软件中设置浪涌电流参数来控制电池的最大浪涌电流。软件会根据配置的系统级参数（例如升压输出电容器、所需的浪涌电流等）在 `CLASSH_TUNING_x[23:0]` 寄存器中生成所需的系数。

6.3.1.5 2S 电池模式

TAS2120 可配置为用于不同的电池系统，例如单节串联 (1S) 锂离子电池 (2.5V 至 5.5V) 或 2 节串联 (2S) 串联电池 (4.7V 至 10V)。当为该器件选择 2S 电池时，下图显示了系统中连接 2S 电池的概念连接。当选择 2S 电池供电时，器件的 VBAT 引脚用于偏置内部块，需要由介于 3.0V 和 5.5V 之间的外部电源供电。

内部电池电压监测器需要切换到检测 `VBAT_SNS` 引脚上的电压，而不是默认在 VBAT 引脚上进行检测。`SEL_VBAT_MODE[1:0]` 用于配置内部电压监测以及在 1S 和 2S 电池系统之间选择器件配置。

当 `SEL_VBAT_MODE[1:0]` 被设置为“10”（即 2S 运行模式）时，需要根据 `VBAT_BIAS_SELx` 寄存器配置器件内部偏置电压。如果 VBAT 引脚电压通过中心抽头提供（即等于 2S 电池电压的一半），则需要将 `VBAT_BIAS_SEL1` 设置为高电平。对于其他 VBAT 电压配置，`VBAT_BIAS_SEL1` 应设置为低电平，并且应选择适当的 `VBAT_BIAS_SEL2` 配置。

表 6-12. 电池模式选择

<code>SEL_VBAT_MODE[1:0]</code>	配置
00 (默认值)	在 VBAT 引脚上进行电压监测。 1S 运行模式
01	在 <code>VBAT_SNS</code> 引脚上进行电压监测。 1S 运行模式
10	在 <code>VBAT_SNS</code> 引脚上进行电压监测。 2S 运行模式
11	保留

表 6-13. VBAT 引脚偏置电压选择器

<code>VBAT_BIAS_SEL1</code>	配置
0 (默认值)	基于 <code>VBAT_BIAS_SEL2</code> 寄存器的 VBAT 引脚偏置
1	VBAT 引脚电压是 2S 电池电压的 一半

表 6-14. VBAT 引脚偏置电压选择器

<code>VBAT_BIAS_SEL2[1:0]</code>	配置
00	保留
01 (默认值)	最小 VBAT 引脚电压 > 2.9V
10	最小 VBAT 引脚电压 > 3.3V
11	最小 VBAT 引脚电压 > 3.7V

6.3.1.6 外部 PVDD 模式

可以通过将 *BST_EN* 寄存器设置为低电平来禁用 TAS2120 的内部升压。使用外部 PVDD 模式时，D 类放大器直接由 PVDD 引脚上的电压源供电。需要使用 PPC3 软件更新器件配置，以将器件配置为外部 PVDD 运行模式所需的性能配置。

6.3.2 故障和状态

在上电时序期间，上电复位电路 (POR) 监测 VDD 和 IOVDD 引脚并使器件保持在复位状态 (包括所有配置寄存器)，直到电源有效。VDD 或 IOVDD 上的任何电源电压骤降至 UVLO 电压阈值以下都会立即使器件和所有寄存器配置复位。

在运行模式期间，器件会监测内部器件状态和故障情况，并可以使用 IRQZ 中断引脚和基于 I²C 的内部中断寄存器向主机通知错误和状态情况。可以通过配置相应的中断屏蔽寄存器位来屏蔽 IRQZ 引脚中的中断生成。

表 6-15 列出了器件监测的不同故障和中断以及相应的配置位，用于启用/禁用中断产生和读取 I2C 中断状态。

表 6-15. 故障和中断

类别	中断	中断屏蔽寄存器位	默认屏蔽状态	中断锁存状态位
限制器和欠压保护 节 6.4.2.4	检测到欠压	INT_MASK0[3]	不屏蔽	INT_LTCH0[3]
	BOP 有效	INT_MASK0[2]	不屏蔽	INT_LTCH0[2]
	BOP 无限保持	INT_MASK0[7]	不屏蔽	INT_LTCH0[7]
	限制器运行	INT_MASK0[4]	不屏蔽	INT_LTCH0[4]
	限制器衰减	INT_MASK0[6]	不屏蔽	INT_LTCH0[6]
	电源电压低于拐点	INT_MASK0[5]	不屏蔽	INT_LTCH0[5]
电源电压监测 节 6.4.5	PVDD 过压	INT_MASK3[2]	不屏蔽	INT_LTCH3[2]
	PVDD 欠压	INT_MASK1[7]	不屏蔽	INT_LTCH1[7]
	VBAT2S 电源欠压	INT_MASK1[6]	不屏蔽	INT_LTCH1[6]
	VBAT 电源欠压	INT_MASK4[7]	不屏蔽	INT_LTCH4[7]
热保护 节 6.4.6	135°C 热警告	INT_MASK1[4]	已屏蔽	INT_LTCH1[4]
	125°C 热警告	INT_MASK1[3]	已屏蔽	INT_LTCH1[3]
	115°C 热警告	INT_MASK1[2]	已屏蔽	INT_LTCH1[2]
	105°C 热警告	INT_MASK1[1]	已屏蔽	INT_LTCH1[1]
	过热错误	INT_MASK3[7]	不屏蔽	INT_LTCH3[7]
时钟保护 节 6.4.7.1	时钟错误	INT_MASK2[3]	不屏蔽	INT_LTCH2[3]
	上电前时钟错误	INT_MASK4[2]	不屏蔽	INT_LTCH4[2]
	时钟比率变化错误	INT_MASK2[2]	不屏蔽	INT_LTCH2[2]
	Fs 变化错误	INT_MASK2[1]	不屏蔽	INT_LTCH2[1]
	Fs 无效错误	INT_MASK2[0]	不屏蔽	INT_LTCH2[0]
	帧不同步	INT_MASK2[5]	不屏蔽	INT_LTCH2[5]
	内部 PLL 时钟错误	INT_MASK2[4]	不屏蔽	INT_LTCH2[4]
	数字看门狗	INT_MASK2[7]	不屏蔽	INT_LTCH2[7]
其他保护和状态	D 类过流错误	INT_MASK3[3]	不屏蔽	INT_LTCH3[3]
	设备激活	INT_MASK0[1]	已屏蔽	INT_LTCH0[1]

6.3.2.1 中断生成和清除

IRQZ 引是一个漏极开路输出，在未屏蔽的故障条件下置位为低电平，因此必须通过一个电阻器将其上拉至 IOVDD。器件中提供了一个内部上拉电阻器 (18kΩ)，可通过设置 *IRQZ_PU* 寄存器位对其进行评估。

可以使用 `IRQZ_PIN_CFG[1:0]` 寄存器配置 IRQZ 引脚上的中断生成。对于具有自动重试功能的中断，可以使用 `RETRY_WAIT_TIME` 寄存器来配置重试计时器。通过将 `IRQZ_POL` 寄存器位设置为高电平，可以将中断引脚极性从默认的低电平有效更改为高电平有效。

可以通过将 `INT_CLR_LTCH` 位设置为高电平来清除任何锁存中断。此位将自行清除，并在中断被清除后自动更新为低电平。通过硬件关断（通过拉低 `SDZ` 引脚）或使用 `SW_RESET` 位进行软件复位也可以清除中断。

表 6-16. IRQZ 引脚配置

<code>IRQZ_PIN_CFG[1:0]</code>	配置
00	保留
01 (默认值)	任何未屏蔽的锁存中断生成中断
10	保留
11	任何未屏蔽锁存中断每 4ms 生成一个持续 2 至 4ms 的中断

表 6-17. 重试等待计时器

<code>RETRY_WAIT_TIME</code>	配置
0 (默认值)	每 1.5 秒重试一次
1	每 100ms 重试一次

6.4 特性说明

6.4.1 PurePath™ Console 3 软件

可以使用 PurePath Console 3 (PPC3) 软件来执行 TAS2120 的高级特性和器件配置。可以从 TI 网站下载并安装基本软件 PPC3。安装后，可以从 PPC3 内部下载 TAS2120 应用程序。PPC3 工具计算必要的寄存器系数（如下部分所述）。根据 GUI 中选择的系统配置选项，使用名为 *TUNING* 的寄存器优化器件性能。这是配置器件的建议方法。TAS2120 应用程序计算并更新器件后，可以使用 PPC3 工具读回寄存器值，以进行最终系统集成。

6.4.2 播放信号路径

6.4.2.1 数字音量控制和放大器输出电平

通过设置放大器的模拟增益电平 (A_{AMP}) 和数字音量控制 (A_{DVC}) 来控制从音频输入到扬声器端子的增益。方程式 1 用于计算放大器输出电压。放大器模拟增益设置应在回放通道上电之前设置，并且在通道处于工作状态时不应更改。可在通道处于工作状态时修改数字音量控制，并且还支持软音量斜升/斜降功能，从而实现输出电压从一个电平到另一个电平的平滑转换。

$$V_{AMP} = Input + A_{dvc} + A_{AMP} \text{ dBV} \quad (1)$$

其中

- V_{AMP} 是以 dBV 为单位的放大器输出电压
- *Input* 是相对于 0dBFS 的数字输入振幅，以 dB 为单位
- A_{DVC} 是数字音量控制设置，范围为 6dB 至 -110dB，阶跃为 0.5dB
- A_{AMP} 是放大器输出电平设置，范围为 -0.071dBV 至 21.0dBV，阶跃为 0.5017dBV。

放大器输出电平设置以 dBV 为单位（dB 对应于 $1V_{rms}$ ），满标度数字音频输入 (0dBFS) 和数字音量控制设置为 0dB。应该注意的是，由于放大器中存在模拟削波，这些电平可能无法实现，因此它们应仅用于传达增益。

下表显示了可通过 `AMP_LVL` 寄存器编程的增益设置。当 `AMP_LVL` 设置为低于 9dBV 时，回放通道将自动配置为低噪声模式或接收器运行模式。

表 6-18. 放大器输出电平设置

AMP_LVL[5:0]	满标度输出	
	dBV	V _{PEAK} (V)
0x00	21.000	15.9
0x01	20.498	15.0
0x02	19.997	14.1
0x03	19.495	13.3
0x04	18.993	12.6
...
0x27	1.434	1.7
0x28	0.932	1.6
0x29	0.430	1.5
0x2A	-0.071	1.4
0x2B-0x3F	保留	保留

当数字音量控制发生变化时，器件会根据 *DVC_SLEW_RATE* 寄存器位将音量斜升到新设置。如果 *DVC_SLEW_RATE* 被设置为 0x7FFFFFFF，则禁用音量斜坡。当系统主机处理音量斜坡时，这可用于加速启动、关闭和数字音量更改。禁用音量斜坡后，输入音频数据流应在器件关断和上电期间保持数字静音，以避免任何咔嗒声和砰砰声。

通过将 *DVC_LEVEL* 设置为 0x000000，可将该器件置于基于软件的静音模式。

数字电压控制寄存器 *DVC_LEVEL* 和 *DVC_SLEW_RATE* 寄存器可以使用 PPC3 软件 (请参阅节 6.4.1) 进行配置。

表 6-19. 数字音量控制

DVC_LEVEL[23:0]	音量 (dB)
0x000000	软件 MUTE
0x00000D (MIN)	-110
...	...
0x400000	0 (默认值)
...	...
0x7FB261 (最大值)	6

表 6-20. 数字音量斜坡速率

DVC_SLEW_RATE[23:0]	48kHz 下的
0x00036A	1000ms
...	...
0x034A51	4ms (默认)
...	...
0x7FFFFFFF	0 - 禁用斜坡

6.4.2.2 高通滤波器

音频播放信号中直流和低频成分过多会损坏扬声器。回放路径采用高通滤波器 (HPF) 来防止发生这种情况。HPF 是一个一阶滤波器，可以使用 *AUDIO_HPF_N0*、*AUDIO_HPF_N1*、*AUDIO_HPF_D1* 寄存器在 48ksps fs 下更改默认的 2Hz 频率。HPF 滤波器频率随 *FSYNC* 时钟的变化而变化，并且可以重新配置以实现不同 *FSYNC* 时钟频率所需的截止频率。还可以更改系数以相应地禁用 HPF 系数。应使用 PPC3 软件计算和设置这些系数，请参阅节 6.4.1。

6.4.2.3 D 类放大器

TAS2120 集成了高性能 D 类放大器，具有低空闲通道噪声、低失真和高 PSRR。D 类放大器以源自 SBCLK 频率的时钟频率进行开关，并且始终与输入时钟源同步。SAMP_RATE_CFG 寄存器支持根据 44.1kHz 和 48kHz 倍数来选择输入时钟源。

表 6-21. 采样率配置

SAMP_RATE_CFG	配置
0 (默认值)	音频数据速率是 48ksps 的倍数/约数
1	音频数据速率是 44.1ksps 的倍数/约数

为了改进 EMI 性能，D 类放大器支持可编程边沿速率控制 (ERC) 和 D 类时钟展频调制 (SSM)。

D 类的边缘速率可使用 CLASSD_OUTPUT_EDGERATE_CTRL[1:0] 寄存器来控制。默认情况下，D 类输出边沿速率配置为最快设置，以实现系统高效率。可使用其他配置设置来降低 D 类输出边沿速率，从而降低高频下的 EMI 能量，这同时会降低效率。输出边沿速率的确切变化率取决于输出负载条件，下表中提到的值是默认负载条件下的近似边沿速率水平。

表 6-22. D 类输出边沿速率控制

CLASSD_OUTPUT_EDGERATE_CTRL[1:0]	配置
00	0.5V/ns 的 D 类输出边沿速率
01	1.0V/ns 的 D 类输出边沿速率
10	保留
11 (默认值)	2V/ns 的 D 类输出边沿速率

D 类放大器在每个输出功率 FET (包括 PVDD 高侧、VDD 高侧和接地功率 FET) 上都具有过流保护。

当输出在噪声门模式期间停止开关时，可以使用 CLASSD_HIZ_MODE 控制寄存器来控制 D 类放大器输出阻抗。

表 6-23. D 类高阻态模式控制

CLASSD_HIZ_MODE	配置
0 (默认值)	通过 2.5kΩ 电阻下拉输出
1	通过大于 13kΩ 的电阻下拉输出

6.4.2.4 具有欠压保护功能的电源跟踪限制器

TAS2120 会监控 D 类电源电压 (VBAT 或 PVDD) 和音频信号，以便在音频信号峰值超过可编程阈值时自动降低增益。这有助于防止削波并在电池充电结束的情况下延长播放时间。限制器和欠压模块根据信号电平、通道增益和所选电源电压的条件计算所需的信号衰减。

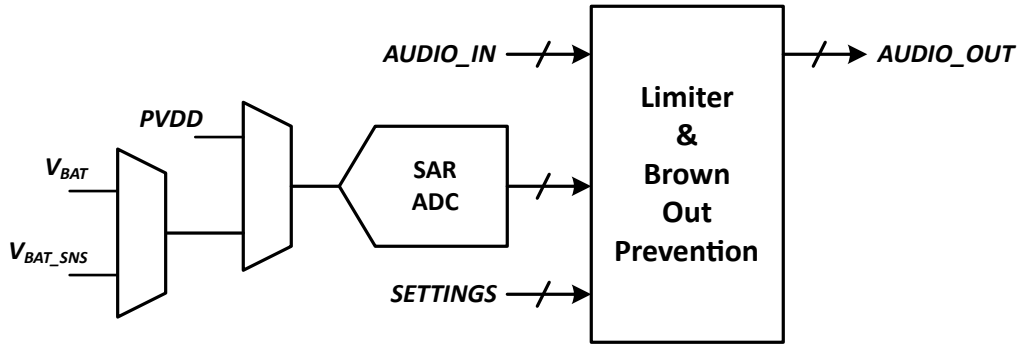


图 6-2. 限制器和欠压保护模块

欠压保护 (BOP) 模块提供优先输入，以便对电池电源的瞬态突降作出快速响应。可以通过将寄存器位 *BOP_EN* 配置为高电平来启用 BOP 功能。根据系统配置需求，可以使用 *BOP_SRC* 寄存器位将跟踪用于确定欠压条件的电源电压配置为 V_{BAT} / V_{BAT_SNS} 或 *PVDD*。当所选电源降至通过设置寄存器 *BOP_THR_LVL[23:0]* 配置的欠压阈值以下时，BOP 将开始降低增益。可以通过设置 *BOP_ATK_RATE[23:0]* 寄存器来配置增益降低速率 (dB/样本)。当 V_{BAT} 电源升至欠压阈值以上时，BOP 将在已编程的保持计时器 *BOP_HLD_COUNT[23:0]* 之后开始释放增益。BOP 功能使用 *LIM_RLS_RATE[23:0]* 寄存器设置在欠压事件后释放。释放速率是以 dB/样本比率表示的增益增加速率。在 BOP 事件期间，限制器更新将暂停。这是为了防止限制器在 BOP 事件期间释放。

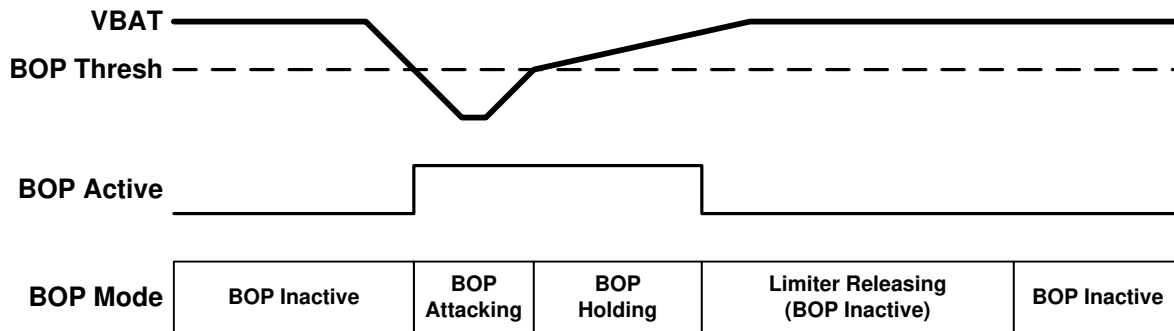


图 6-3. 欠压保护事件

通过将寄存器位 *BOP_INF_HLD* 设置为高电平，可以将器件配置为在检测到 BOP 事件时保持增益衰减。当该位被编程为高电平时，限制器和 BOP 模块不会释放增益衰减，并且会将器件保持在编程的最小增益衰减水平，直到通过将寄存器位 *BOP_HLD_CLR* 设置为高电平来清除无限保持。保持清除位将自行清除，并在保持被清除后自动复位至低电平状态。

如果 BOP 增益衰减无法缓解电池电压下降，则可以设置硬欠压电平来关断器件。当 *BOPSD_EN* 位被设置为高电平时，会启用基于欠压的器件关断，当电池电压低于 *BOSD_THR_LVL[23:0]* 寄存器位设置的电压阈值时，器件关断。

可以通过 *LIM_MAX_ATN* 寄存器来配置限制器和欠压保护功能所应用的最大衰减水平。该衰减限制在各个功能之间共用。例如，如果最大衰减设置为 6dB，而限制器增益降低 4dB，欠压保护功能只能再将增益降低 2dB。如果限制器或欠压保护功能正在启动并且达到最大衰减，则不会进一步降低增益。

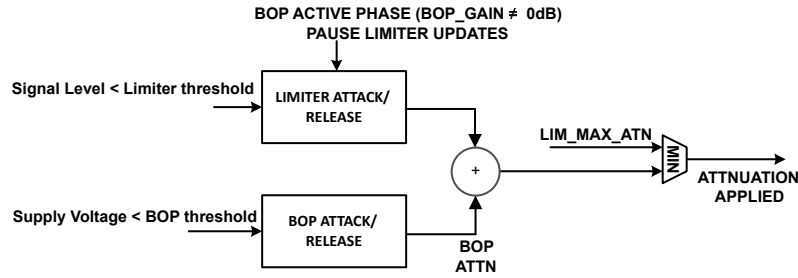


图 6-4. 限制器和欠压增益衰减

6.4.2.4.1 电压限制器和削波保护

可以使用 `LIM_MODE[1:0]` 寄存器配置电源跟踪限制器。在 VBAT 电压模式下，限制器跟踪 VBAT 电源电压以用于电压限制器，而在 PVDD 电压模式下，限制器跟踪 PVDD 电压以用于外部 PVDD 模式的用例。

表 6-24. 限制器模式选择

<code>LIM_MODE[1:0]</code>	配置
00 (默认值)	禁用
01	基于 VBAT 电压的限制器
10	基于 PVDD 电压的限制器
11	保留

限制器可以配置为根据固定信号阈值电平降低输出信号，或者可以根据跟踪所选电源电压的动态阈值衰减信号。寄存器位 `SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE` 可启用动态电源跟踪，可用于在系统中电源电压发生变化时限制削波失真。

表 6-25. 限制器动态电源余量跟踪模式

<code>SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE</code>	配置
0 (默认值)	禁用
1	被启用。限制器阈值会根据受监测电源电压的固定百分比进行动态更改。

当 `SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE` 被设置为高电平时，限制器将阈值设置为受监测电源电压的固定百分比。当输出信号电平大于配置的阈值时，限制器开始降低增益。例如，如果希望电压限制比电源电压低 10%，则 `LIM_SLOPE[23:0]` 被配置为 0.9，阈值通过受监测电源电压乘以 1.1 计算得出。类似地，如果 `LIM_SLOPE[23:0]` 被配置为 > 1.0，则限制器阈值将被设置为高于电源电压，并且会发生少量受控削波。

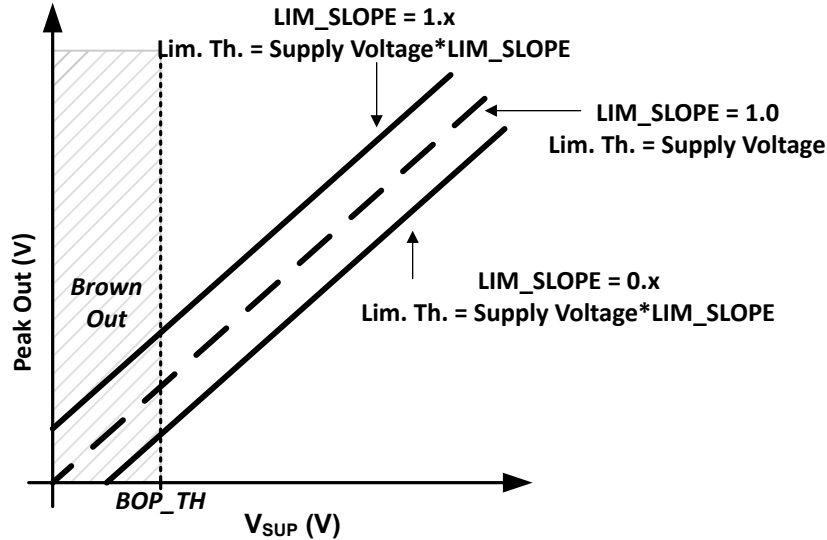


图 6-5. 具有动态电源余量的限制器

当 `SUPPLY_HEADROOM_LIM_MODE` 被设置为低电平时，如果输出信号电平大于限制器阈值，则限制器开始降低增益。限制器可配置为以最小阈值跟踪低于可编程拐点的所选电源。下面的图 6-6 显示了将限制器配置为限制到一个恒定电平，而不管所选电源电平如何。要实现此行为，请使用 `LIM_TH_MAX[23:0]` 将限制器最大阈值设置为所需水平。使用 `LIM_INF_PT[23:0]` 将限制器拐点设置为低于允许的最小电源电压设置。限制器最小阈值寄存器 `LIM_TH_MIN[23:0]` 不会影响此用例中的限制器行为。

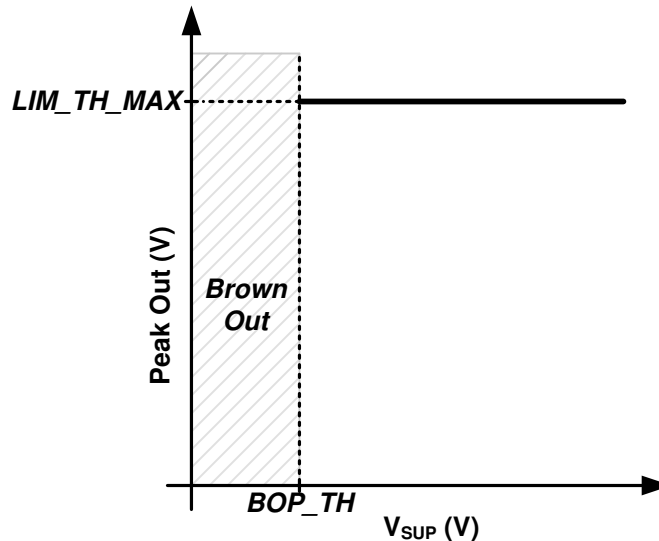


图 6-6. 具有固定阈值的限制器

图 6-7 显示了如何配置限制器以跟踪低于阈值的所选电源，而无需设置最小阈值。将 `LIM_TH_MAX[23:0]` 寄存器设置为所需的阈值，并将 `LIM_INF_PT[23:0]` 寄存器设置为限制器开始降低所选电源阈值的所需拐点。`LIM_SLOPE[23:0]` 寄存器位可用于更改限制器跟踪电源电压的斜率（以 V/V 为单位）。例如，如果斜率值为 $1V/V$ ，则电源电压每降低 $1V$ ，限制器阈值就会降低 $1V$ 。将 `LIM_TH_MIN[23:0]` 位编程为低于所选电源的最小值，以防止限制器在跟踪所选电源时出现最小阈值降低。

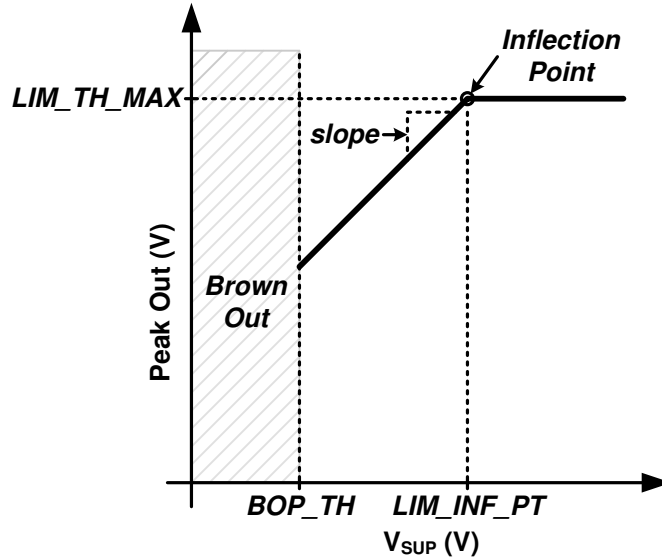


图 6-7. 具有拐点的限制器

要实现跟踪所选电源低于阈值的限制器，请按照上一个示例中的说明配置限制器，但需要将 `LIM_TH_MIN[23:0]` 寄存器编程为所需的最小阈值。下面的图 6-8 展示了这种情况。

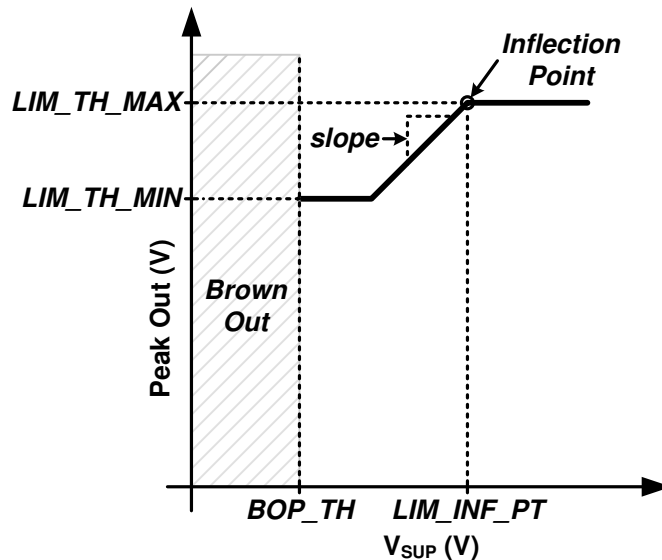


图 6-8. 具有拐点和最小阈值的限制器

限制器具有可配置的启动速率 (dB/样本)、保持时间 (样本数) 和释放速率 (db/样本)，可通过 `LIM_ATK_RATE[23:0]`、`LIM_HLD_COUNT[23:0]`、`LIM_RLS_RATE[23:0]` 寄存器位获取。

6.4.2.5 音调发生器

TAS2120 可以使用集成音调发生器在内部生成正弦音调。可以通过将寄存器位 `INTERNAL_TONE_GEN_ENZ` 配置为低电平来启用该特性。通过将 `INTERNAL_TONE_PLAYBACK_EN` 位配置为高电平，音调信号将开始在输出端回放。当设置为高电平时，器件将根据编程的 `TONE_GEN_CNTRL_xx` 寄存器开始生成正弦音调。音调发生器可以生成从 16Hz 到最大频率 $0.45 \cdot F_s$ 的任何频率，其中 F_s 是输入数字时钟的采样率。也可以使用 `TONE_GEN_CNTRL_xx` 寄存器来控制音调信号的振幅。建议使用 PPC3 软件对音调频率和振幅进行编程。

内部生成的音调可以与传入的音频流混合，或者可以替换输入音频流，仅使用 `INTERNAL_TONE_MIXING_EN` 寄存器生成音调信号。

表 6-26. 内部音调发生器混合选项

<code>INTERNAL_TONE_MIXING_EN</code>	配置
0	仅生成内部音调。
1 (默认值)	内部生成的音调与输入音频数据混合并一起播放。

音调发生器可以使用 `BCLK` 等外部时钟源，或者可以使用内部振荡器生成音调信号（使用 `INTERNAL_TONE_CLK_SEL` 寄存器），即使没有外部时钟源也是如此。

表 6-27. 内部音调时钟源选择

<code>INTERNAL_TONE_CLK_SEL</code>	配置
0 (默认值)	音调发生器使用外部时钟
1	音调发生器使用内部振荡器

6.4.3 数字音频串行接口

该器件提供灵活的音频串行接口 (ASI) 端口。该端口可配置为支持多种格式，包括立体声 I²S、左对齐和 TDM。通过 `SDIN` 引脚提供单音频播放。`SDOUT` 引脚用于传输样本流，包括 `PVDD` 电压、`VBAT` 电压、内核温度、状态以及用于回声基准的音频。

TDM 串行音频端口在 44.1/48kHz 采样率下支持多达 16 个 32 位时隙，在 88.2/96kHz 采样率下支持多达 8 个 32 位时隙，在 176.4/192kHz 采样率下支持多达 4 个 32 位时隙。该器件支持 2 个宽度为 32 位的时隙，以及 4 个或 8 个宽度为 16 位、24 位或 32 位的时隙。器件可自动检测时隙数，无需编程。TDM 总线上检测到的 PCM 数据采样率以及 `SBCLK` 与 `FSYNC` 之比会分别在只读寄存器位 `FS_RATE_DETECTED[2:0]` 和 `FS_RATIO_DETECTED[3:0]` 上报告。

表 6-28. 检测到的 PCM 数据采样率

<code>FS_RATE_DETECTED[2:0]</code> (只读)	设置
000	保留
001	14.7kHz/16kHz
010	22.05kHz/24kHz
011	29.4kHz/32kHz
100 (默认值)	44.1kHz/48kHz
101	88.2kHz/96kHz
110	176.4kHz/192kHz
111	错误条件

帧以 `FSYNC` 从高电平转换到低电平或从低电平转换到高电平（由 `FRAME_START` 寄存器位设置）开始。`FSYNC` 和 `SDIN` 由 `SBCLK` 使用由 `RX_EDGE` 寄存器位设置的上升沿或下降沿进行采样。`RX_OFFSET[4:0]` 寄存器位定义从 `FSYNC` 转换到时隙 0 开始的 `SBCLK` 周期数。这通常设置为值 0（对于左对齐）和 1（对于 I²S 格式）。

`RX_SLEN[1:0]` 寄存器位将 `RX` 时隙的长度设置为 16、24 或 32（默认）位。时隙内音频样本字的长度由 `RX_WLEN[1:0]` 寄存器位配置。默认情况下，`RX` 端口将使时隙内的音频样本左对齐，但这可以通过 `RX_JUSTIFY` 寄存器位更改为右对齐。器件支持单声道和立体声下混音播放 ($(L+R)/2$)。默认情况下，器件将从等于 I²C 基地址偏移量（由 `AD1` 和 `AD2` 引脚设置）的时隙播放单声道。`RX_SCFG[1:0]` 寄存器位可用于将播放源覆盖到左时隙、右时隙或由 `RX_SLOT_R[3:0]` 和 `RX_SLOT_L[3:0]` 寄存器位设置的立体声下混频。

如果时隙选择将接收部分或全部置于帧边界之外，则接收器返回一个空样本，相当于一个数字静音样本。

TDM 端口可以在 SDOUT 引脚上传输多个样本流，包括中断和状态、PVDD 电压、VBAT 电压和内核温度。

SBCLK 的上升沿或下降沿均可用于在 SDOUT 引脚上传输数据。这可以通过设置 *TX_EDGE* 寄存器位来配置。*TX_OFFSET[2:0]* 寄存器位定义从帧开始到帧 0 开始的 SBCLK 周期数。这会编程为 0 (对于左对齐格式) 和 1 (对于 I²S 格式)。TDM TX 可以发送逻辑 0 或高阻态，具体取决于 *TX_FILL* 寄存器位的设置。当所有器件都驱动高阻态时，可选的总线保持器可以弱保持 SDOUT 引脚的状态。由于 SDOUT 上只需要一个总线保持器，因此可以通过 *TX_KEEPEEN* 寄存器位禁用此功能。使用 *TX_KEEPLN* 寄存器位可以将总线保持器配置为仅将总线保持 1 个 LSB 或始终保持 (永久)。此外，可以使用 *TX_KEEPCY* 寄存器位将保持器 LSB 驱动一个完整周期或半个周期。

器件还支持 PVDD 和 VBAT 输入电压的监测和 TDM 传输。对于 PVDD 时隙，可以使用使能和长度设置 *PVDD_SLOT[5:0]*、*PVDD_TX* 和 *PVDD_SLEN* 寄存器位。同样，对于 VBAT 时隙，可以使用使能和长度设置 *VBAT_SLOT[5:0]*、*VBAT_TX* 和 *VBAT_SLEN* 寄存器位。内核温度也能够以相同的方式从器件传输。可以使用 *TEMP_TX* 和 *TEMP_SLOT [5:0]* 寄存器位来完成内核温度的使能和时隙设置。

STATUS_SLOT[5:0] 寄存器位提供了有关时隙状态的信息。将 *STATUS_TX* 寄存器位设置为高电平会启用状态发送。状态时隙长度始终为 8 位，表 6-29 汇总了在启用状态发送时发送的状态位信息。如果时隙选择将传输置于帧边界之外，则发送器将在帧边界截断传输。

表 6-29. 发送的状态位

状态时隙位位置	状态信号
位 0	PVDD UVLO 状态位
位 1	过流保护状态位
位 2	过热保护状态位
位 3	欠压保护有效状态位
位 4	限制器有效状态位
位 5	噪声门模式状态位
位 6	Y 桥状态位。1 = PVDD 开关, 0 = VDD 开关
位 7	器件有效状态位

6.4.3.1 数字环回

该器件支持环回功能，可在两个级别将 SDIN 数据环回到 SDOUT。当通过 *TDM_LOOPBACK* 寄存器位启用该功能时，会在 IO 引脚级别完成环回，器件内不进行任何 ASI 数据解码。另一个选项是通过 *TDM_DESER_LOOPBACK* 寄存器位启用环回功能，在这种情况下，SDIN 数据首先通过器件内的 ASI 协议解码，然后通过 SDOUT 发送回来。这些 SDIN 到 SDOUT 环回选项可用于音频系统的板级调试。

器件还可以通过 SDOUT 信号在内部信号处理块 (例如限制器、BOP 等) 的末尾环回回声基准数字音频数据。这使音频系统能够在连接到器件的主机处理器中执行噪声和回声消除算法。可以通过配置 *AUDIO_TX* 寄存器位来启用回声基准。可以使用 *AUDIO_SLEN* 和 *AUDIO_SLOT[5:0]* 寄存器位选择时隙长度和时隙。

6.4.4 升压

TAS2120 内部处理算法会在需要时自动启用升压。超前算法可监控电池电压和数字音频流。当扬声器输出接近电池电压时，会及时启用升压以提供所需的扬声器输出电压。当不再需要升压转换器时，会将其禁用并旁路以更大限度地提高效率。可以将升压配置为两种模式之一。第一种是低浪涌 (G 类)，仅支持升压关断，具有最低的浪涌电流。第二种是高效率 (H 类)，其中升压电压电平调整为刚好高于所需的值。该模式更高效，但浪涌电流更高，可快速转换电平。这可以通过使用 *BST_MODE[1:0]* 寄存器位来配置。

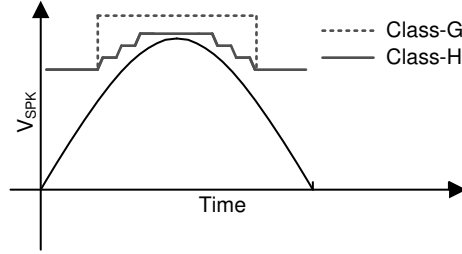


图 6-9. 升压模式信号跟踪示例

表 6-30. 升压模式

BST_MODE[1:0]	升压模式
00	H 类 - 高效率 (默认)
01	G 类 - 低浪涌电流
10	常开
11	始终关闭 - 直通

可以使用 *BST_EN* 寄存器来启用和禁用升压。当使用外部电源通过 *PVDD* 引脚驱动 D 类放大器时，应禁用升压，并且 *SW* 引脚应保持悬空。

表 6-31. 升压启用

BST_EN	升压
0	禁用 (外部 <i>PVDD</i> 模式)
1	启用 (默认设置)

最大升压电压由 *VBOOST_MAX_CTRL[7:0]* 设置。在 G 类模式下运行时，升压 (如果需要) 为该电压。在 H 类运行模式下，升压电压是根据音频信号自动选择的，但不会超过该设置值。在 H 类模式下，H 类控制器以 33mV 的最小阶跃来控制升压，以生成所需的 *PVDD* 电压。器件生成的最大升压电压由 *VBOOST_MAX_CTRL[7:0]* 控制，能够以 66mV 的阶跃大小进行配置。

表 6-32. 升压最大调节电压

VBOOST_MAX_CTRL[7:0]	升压电压 (V)
0x00 - 0x53	保留
0x54	5.54V
0x55	5.61V
...	... 66mV 阶跃/LSB 阶跃 ...
0xA7	11.02V (默认值)
...	... 66mV 阶跃/LSB 阶跃 ...
0xE0	14.75V
0xE6 - 0xFF	保留

在轻负载 (例如正弦波的过零点附近) 时，升压自动进入 PFM 模式以提高系统效率。当升压以 PFM 模式运行时，可以使用 *BST_MIN_FREQ_SEL* 来调整最小脉冲频率。设置较高的 PFM 频率可确保升压频率始终高于设置的阈值，但这样会增加系统功耗。

表 6-33. 有效模式 PFM 频率下限

BST_MIN_FREQ_SEL[1:0]	下限
00	无下限 (默认)
01	25kHz
10	50kHz

表 6-33. 有效模式 PFM 频率下限 (续)

BST_MIN_FREQ_SEL[1:0]	下限
11	保留

通过使用 *BST_ILIM[23:0]* 寄存器来控制升压消耗的峰值电流，该寄存器限制从 VBAT 电源消耗的电流。该设置可以灵活地为各种饱和和电流选择电感器。系统应始终使用最小饱和电流 (I_{SAT}) 至少比编程的 *BST_ILIM* 设置高 5% 的电感器。如果电感器的 I_{SAT} 低于 *BST_ILIM* 设置，则升压电路会变得不稳定。可以使用 PPC3 软件以 39.1mA 阶跃在 1.5A 至 5.1A 范围内调整电流限制。

要更改 *BST_ILIM*、*VBOOST_MAX_CTRL* 等升压配置，需要重新调优 *CLASSH_TUNING_xx[23:0]* 寄存器等器件参数，以在确保无功能故障的同时实现最佳性能。应使用 PPC3 工具更改此配置，以自动重新配置所有关联的器件参数。

对于多通道系统，可以移动升压相位，以确保每个器件将在不同的时间点从电池汲取峰值电流，从而降低电池提供的瞬时峰值电流。可以使用 *BOOST_PHASE_SYNC_EN* 启用多个器件之间的升压同步。可以使用 i2c 目标地址器件（使用 *BOOST_PHASE_FROM_ADDRESS_PIN* 寄存器进行检测）将各个器件升压相位自动配置为不同的值，也可以使用 *BOOST_PHASE* 寄存器手动对其进行配置。升压相移由每个器件使用 *FSYNC* 脉冲同步每个器件来完成，所有需要升压相位同步的器件应连接到来自系统中主机的同一 *FSYNC*。

表 6-34. 升压同步

BOOST_PHASE_SYNC_EN	状态
0	禁用
1	启用 (默认设置)

表 6-35. 通过 i2c 目标地址进行升压相位选择

BOOST_PHASE_FROM_ADDRESS_PIN	状态
0	禁用
1	启用 (默认设置)

表 6-36. 升压相位手动选择 (当 *BOOST_PHASE_FORM_ADDRESS_PIN = 0* 时)

BOOST_PHASE[1:0]	相位延迟
00	相移为 0ns (默认设置)
01	相移为 65ns (对于最大时钟, 约为 90°)
10	相移为 130ns (对于最大时钟, 约为 180°)
11	相移为 195ns (对于最大时钟, 约为 270°)

6.4.5 电源电压监测

TAS2120 集成了 SAR ADC 来监测电源电压引脚 VBAT 或 VBAT_SNS 和 PVDD。检测电压用于内部器件特性和保护，也可通过数字数据总线流式传输或通过 i2c 寄存器读取。

可以根据寄存器 *SEL_VBAT_MODE[1:0]* 通过 VBAT 或 VBAT_SNS 引脚检测电池电压

表 6-37. 电池模式选择

SEL_VBAT_MODE[1:0]	配置
00 (默认值)	在 VBAT 引脚上进行电压监测。 1S 运行模式

表 6-37. 电池模式选择 (续)

SEL_VBAT_MODE[1:0]	配置
01	在 VBAT_SNS 引脚上进行电压监测。1S 运行模式
10	在 VBAT_SNS 引脚上进行电压监测。2S 运行模式
11	保留

与 PVDD 引脚电压相比，监测器 ADC 以更高的速率对 VBAT 引脚进行采样。例如，在外部 PVDD 运行模式下，可以交换该采样速度，以优先考虑 PVDD 引脚采样率，而非 VBAT。

表 6-38. 电源监测采样率

SUPPLY_SAMPLING_RATE	配置
0 (默认值)	VBAT 采样率高于 PVDD
1	PVDD 采样率高于 VBAT

VBAT 和 PVDD 监测电压存储在寄存器 VBAT_CNV 和 PVDD_CNV 寄存器中，可以使用 i2c 命令进行读取。

电源监测器还用于电压保护，例如 VBAT 欠压、PVDD 过压和欠压以及 VBAT2S 欠压。电压保护功能可监测电源电压，在电压超过保护阈值电平时关断器件。该器件还设置了相应的故障寄存器，可以根据节 6.3.2 所述的配置的中断掩码寄存器在 IRQZ 引脚上产生中断。器件关断后，可以使用 MODE[1:0] 寄存器位使器件重新上电。

PVDD 过压保护基于监测的 PVDD 电压与可编程阈值的比较，该阈值在内部升压模式下可使用 PVDD_OVLO_TH_SEL 进行控制，在外部 PVDD 运行模式下可使用 PVDD_OVLO_TH_SEL_EXT_BOOST 进行控制。PVDD 过压保护默认启用，可以通过将 PVDD_OV_DET_DIS 位设置为高电平来禁用。

表 6-39. PVDD 过压保护阈值，内部升压模式

PVDD_OVLO_TH_SEL[1:0]	配置
00	过压阈值为 13.5V
01	过压阈值为 14V
10	过压阈值为 15V
11 (默认值)	过压阈值为 16V

表 6-40. PVDD 过压保护阈值，外部 PVDD 模式

PVDD_OVLO_TH_SEL_EXT_BOOST[1:0]	配置
00	过压阈值为 13.5V
01 (默认值)	过压阈值为 14V
10	过压阈值为 15V
11	过压阈值为 16V

6.4.6 热保护

TAS2120 具有内部器件结温监测器，可保护器件免受过热影响。当内部温度上升至高于过热阈值时，器件自动关断并在相应的中断寄存器中设置过热标志。如果 OTE_RETRY 位被设置为高电平，则器件可以自动重试上电。设置为高电平时，器件在每次 RETRY_WAIT_TIME 设置后尝试重新上电 (默认重试 1.5 秒)。

除了过热保护，该器件还具有热警告阈值，使系统能够在结温接近关断时生成中断或标志。四个热警告标志分别对应内部温度 105°C、115°C、125°C 和 135°C。每个热警告标志都可以单独设置，以控制 IRQZ 焊盘上的中断

生成。可以使用寄存器 `THERMAL_WARN_MIN_TEMP[23:0]` 和 `THERMAL_WARN_TEMP_STEP[23:0]` 对最低温度和温度警告标志的阶跃大小进行编程。

实时监测到的内部结温存储在寄存器 `TMP_CNV` 中，可以使用 `i2c` 命令进行读取。

6.4.7 时钟和 PLL

在 TDM/I²S 模式下，器件采用 SBCLK 运行。下面的表 6-41 显示了每个采样率的有效 SBCLK 频率以及 SBCLK 与 FSYNC 的比率。对于基于 44.1kHz 的时钟，该表同样适用，但相关比率在 48ksps 和 44.1ksps 之间变化。

虽然支持 192kHz 的采样率，但数据在内部下采样至 96kHz。因此，不应应用大于 40kHz 的音频内容，以防止混叠。此外，这会影响到所有处理块，例如 BOP 和限制器，它们在接收 192kHz 音频时应使用 96kHz fs。

如果通过 `SAMPLE_RATE_CFG` 寄位正确配置了采样率，则只要 SBCLK 与 FSYNC 之比有效，就无需额外配置。器件会自动检测输入 PCM FSYNC 和 BCLK 频率并自动配置为回放音频信号。可以使用只读寄存器 `FS_RATIO_DETECTED` 和 `FS_RATE_DETECTED` 读取检测到的时钟速率。该器件将检测不正确的 SBCLK 频率、SBCLK 与 FSYNC 之比以及播放路径上的音量降低，以便更大限度地减少可闻失真。

表 6-41. 支持的 SBCLK 频率 (MHz) (基于 48kHz 的采样率)

采样率 (kHz)	SBCLK 与 FSYNC 之比													
	16	24	32	48	64	96	128	192	256	384	512	125	250	500
16kHz	不适用	0.384	0.512	0.768	1.024	1.536	2.048	3.072	4.096	6.144	8.192	2	4	8
24kHz	0.384	0.576	0.768	1.152	1.536	2.304	3.072	4.608	6.144	9.216	12.288	3	6	12
32kHz	0.512	0.768	1.024	1.536	2.048	3.072	4.096	6.144	8.192	12.288	16.384	4	8	16
48kHz	0.768	1.152	1.536	2.304	3.072	4.608	6.144	9.216	12.288	18.432	24.576	6	12	24
96kHz	1.536	2.304	3.072	4.608	6.144	9.216	12.288	18.432	24.576	不适用	不适用	12	24	不适用
192kHz	3.072	4.608	6.144	9.216	12.288	18.432	24.576	不适用	不适用	不适用	不适用	24	不适用	不适用

6.4.7.1 基于自动时钟的唤醒和时钟错误

TAS2120 使用 ASI 时钟自动检测功能，支持从工作到关断以及从关断到工作的灵活运行模式转换。当 `MODE[1:0]` 配置为“11”时，器件会根据应用于 ASI 输入引脚上的有效 ASI 时钟信号 (即 BCLK 和 FSYNC) 在工作和软件关断状态之间切换。如果在该模式下未检测到 ASI 时钟，器件将保持软件关断状态，VDD 引脚上具有软件关断模式 I_Q ，直到检测到有效的 BCLK 和 FSYNC 时钟。一旦检测到有效时钟，器件就会在工作状态下上电，直到时钟有效或器件使用软件或硬件关断命令关断。

该器件可以根据 `CLK_ERR_PWR_EN` 的状态在检测到错误的时钟配置时检测并生成中断标志。当该位被设置为高电平时，器件会监测时钟引脚上的活动并使用锁存的中断状态寄存器标记任何错误。器件还可以根据相应中断屏蔽寄存器的状态使用 `IRQZ` 引脚生成中断。当启用错误保护位时，如果检测到时钟错误，器件将通过适当的关断时序自动关断，并尽可能地减少因时钟无效而导致的任何咔嚓声和砰砰声。

当器件处于关断状态时，可以延迟时钟错误检测，以便为系统提供稳定输入时钟所需的时间。时钟错误检测中的该上电延迟由 `CLK_HALT_TIMER` 配置的内部上电前时钟错误检测计时器进行控制。如果器件在 `CLK_HALT_TIMER` 到期结束时未检测到有效时钟，则会在 `INT_LTCH4[2]` 位上标记上电前时钟错误，并根据 `INT_MASK4[2]` 位的状态在 `IRQZ` 引脚上生成相应的中断。当 `MODE[1:0]` 配置为“11” (ASI 模式唤醒) 时，不建议使用值为“000”的 `CLK_HALT_TIMER`，它会阻止器件进入软件关断模式，并在器件关断时增大 VDD I_Q 。

一旦器件上电，就会根据 `CLK_ERR_PWR_EN` 位的状态持续监测外部时钟和内部生成的时钟。如果启用，则会使用时钟错误状态寄存器 `INT_LTCH2[3]` 位标记外部或内部时钟中的任何错误，并根据 `INT_MASK2[3]` 的状态在 `IRQZ` 引脚上生成相应的中断。

为了实现系统灵活性，器件还会针对检测到时钟错误的类型设置错误状态。器件还可以配置为针对任何特定类型的时钟错误在 `IRQZ` 引脚上生成中断，而不是使用通用时钟错误中断生成。下面的表 6-44 说明了不同类型的时钟

错误和相应的状态位以及中断屏蔽寄存器位。可以根据检测到的时钟错误类型设置下表中的一个或多个寄存器位。

如果器件由于任何类型的时钟错误而关断，则可以在 *MODE[1:0]* 设置为“11”时尝试自动重新上电。

表 6-42. 时钟错误检测控制

CLK_ERR_PWR_EN	设置
0	禁用
1	启用 (默认设置)

表 6-43. 时钟暂停计时器

CLK_HALT_TIMER[2:0]	设置
000	禁用 (无限时间)。
001	0.8ms (默认)
010	3.2ms
011	34.1ms
100	68.3ms
101	256ms
110	768ms
111	1.3s

表 6-44. 时钟错误类型说明

时钟错误类型	说明	状态标志寄存器位	IRQZ 生成屏蔽位
时钟错误	有关任何内部或外部时钟配置错误的时钟错误。该位将与在下表其余部分中检测到的特定时钟错误一起设置，上电前时钟错误除外。	INT_LTCH2[3]	INT_MASK2[3]
上电前时钟错误	在 CLK_HALT_TIMER 结束时检测到时钟错误后，在关断模式期间检测到的时钟错误。	INT_LTCH4[2]	INT_MASK4[2]
时钟比率变化错误	由于 FSYNC 与 SBCLK 比率动态变化而检测到的时钟错误。	INT_LTCH2[2]	INT_MASK2[2]
Fs 变化错误	由于 FSYNC 时钟频率动态变化而检测到的时钟错误。	INT_LTCH2[1]	INT_MASK2[1]
Fs 无效错误	由于 FSYNC 时钟频率不正确而检测到的时钟错误。	INT_LTCH2[0]	INT_MASK2[0]
帧不同步	由于帧不同步而检测到时钟错误。	INT_LTCH2[5]	INT_MASK2[5]
内部 PLL 时钟错误	由于内部产生的时钟频率错误而检测到的时钟错误。	INT_LTCH2[4]	INT_MASK2[4]

器件还具有一个数字看门狗计时器，可监测内部数字状态机中的错误，并在检测到此类错误时关断器件。该错误还会在 IRQZ 引脚上生成中断并向主机器件报告错误状态。

6.4.8 数字 IO 引脚

TAS2120 根据施加在 IOVDD 引脚上的电压支持 1.8V 和 3.3V IO 电压电源。

I2S 数字输入引脚具有可选的弱下拉电阻，可防止引脚悬空。HW 关断期间不启用下拉电阻器。默认情况下禁用下拉电阻器，可通过将相应的下拉使能位设置为高电平来启用下拉电阻器。

表 6-45. 数字引脚弱下拉

引脚名称	下拉控制寄存器名称
SDOUT	SDOUT_PD_EN
SDIN	SDIN_PD_EN
FSYNC	FSYNC_PD_EN

表 6-45. 数字引脚弱下拉 (续)

引脚名称	下拉控制寄存器名称
SBCLK	SBCLK_PD_EN

6.5 编程

该器件包含配置寄存器和编程系数，这些系数可以设置为特定系统和应用用例所需的值。这些寄存器称为器件控制寄存器，每个寄存器的宽度均为 8 位，使用页方案进行映射。

每页包含 128 个配置寄存器。所有关键的器件配置寄存器都存储在页 0 中，这是上电时和软件复位后的默认页设置。所有可编程系数寄存器都位于页 2、页 3 和后续页中。通过使用每页上寄存器 0 中的 PAGE[7:0] 位，可以将器件的当前页切换到所需的新页。

6.5.1 I²C 控制接口

该器件作为目标器件支持 I²C 控制协议，能够在标准模式、快速模式和快速+ 模式下运行。使用 I²C 协议通过 SDA 和 SCL 引脚提供器件配置和状态。

6.5.2 I²C 地址选择

TAS2120 可以使用以下四种可选器件地址之一运行：I²C 目标地址定义为 7 个 MSB 后跟读取/写入位。下面的表 6-46 说明了如何选择器件 I²C 地址，该地址对应于设置为 0 的 R/W 位 (即 ADDR[6:0], 1b'0)。当 SDZ 引脚被释放或使用软件复位位将器件复位时，会通过地址引脚进行采样来检测 I²C 地址。

表 6-46. I²C 模式地址选择

I ² C 目标地址	AD2 引脚	AD1 引脚
0x80 (全局地址)	不适用	不适用
0x90	GND	GND
0x92	GND	IOVDD
0x94	IOVDD	GND
0x96	IOVDD	IOVDD

TAS2120 具有 7 位全局 I²C 地址 0x40 (8 位格式 0x80, R/W 位设置为 0)。无论选择了哪些地址引脚，器件启用后，会另外响应此地址的 I²C 命令。这可以在使用多个 TAS2120 器件并在所有器件上对类似设置进行编程时，用于加快器件配置。由于在多器件写入期间，多个器件均响应 I²C 命令，因此无法使用 I²C ACK/NACK。应使用 I²C CRC 功能确保每个器件正确接收 I²C 命令。使用全局地址完成对多个器件的写入后，应根据本地地址检查每个器件上 I2C_CKSUM 寄存器的 CRC 值是否正确。全局 I²C 地址可以使用 I2C_GBL_EN 寄存器来禁用。

表 6-47. I²C 全局地址启用

I2C_GBL_EN	设置
0	禁用
1	启用 (默认设置)

6.5.3 常规 I²C 运行

I²C 总线使用 SDA (数据) 和 SCL (时钟) 这两个信号，通过串行数据传输在系统中的集成电路之间进行通信。地址和数据 8 位字节优先以 MSB 的形式传输。此外，总线上传输的每个字节都由接收器件通过一个响应位进行响应。每次传输操作从控制器器件在总线上驱动启动条件开始，到控制器器件在总线上驱动停止条件结束。当时钟处于逻辑高电平时，总线使用数据引脚 (SDA) 上的转换来指示启动和停止条件。SDA 上从高电平转换到低电平表示启动，而从低电平转换到高电平表示停止。正常的数位转换必须发生在时钟周期的低电平时间内。

控制器器件会驱动一个启动条件，后跟 7 位目标地址和读取/写入 (R/W) 位，以开启与另一个器件的通信，然后等待响应条件。目标器件会在响应时钟期间将 SDA 保持为低电平以指示响应。当发生这种情况时，控制器器件会传

输序列的下一个字节。每个目标器件都通过一个唯一的 7 位目标地址加上 R/W 位 (1 个字节) 进行寻址。所有兼容器件均使用线与连接，通过双向总线共享相同的信号。

在启动和停止条件之间可以传输的字节数没有限制。在传输最后一个字时，控制器器件会生成一个停止条件以释放总线。图 6-10 显示了一般的数据传输序列。

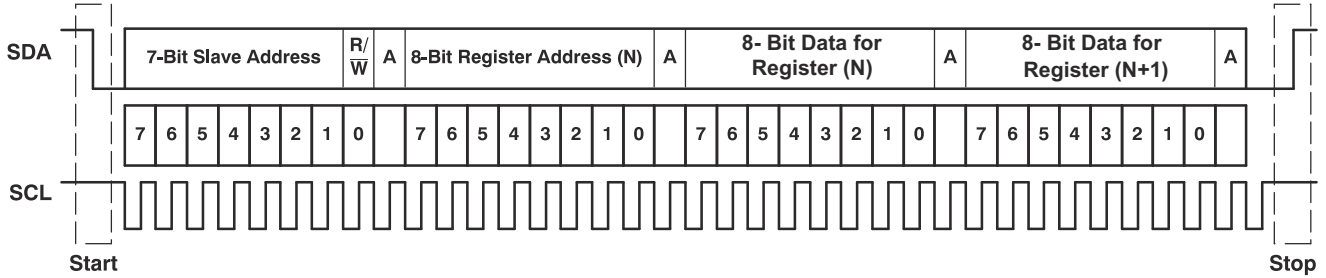


图 6-10. 典型的 I²C 序列

在系统中，对 SDA 和 SCL 信号使用外部上拉电阻器，以设置总线的逻辑高电平。SDA 和 SCL 电压不得超过器件电源电压 IOVDD。

6.5.4 I²C 单字节和多字节传输

该器件的 I²C 接口支持对所有寄存器进行单字节和多字节读取/写入操作。在多字节读取操作期间，只要控制器器件继续响应，器件就会从分配的寄存器开始，一次一个字节地以数据进行响应。

该器件支持顺序 I²C 寻址。对于写入事务，如果发出一个寄存器，然后是该寄存器的数据以及随后的所有剩余寄存器，则发生了顺序 I²C 写入事务。对于 I²C 顺序写入事务，发出的寄存器作为起始点，随后在传输停止或开始之前传输的数据量决定了写入的寄存器数量。

6.5.5 I²C 单字节写入

如图 6-11 所示，单字节数据写入传输始于控制器器件发送启动条件，后跟 I²C 器件地址和读取/写入位。读/写位决定数据传输的方向。对于写入数据传输，读取/写入位必须设置为 0。在接收到正确的 I²C 目标地址和读取/写入位后，该器件会以一个响应位 (ACK) 进行响应。接下来，控制器器件传输对应于正在访问的器件内部寄存器地址的寄存器字节。收到寄存器字节之后，器件会再次用一个响应位 (ACK) 进行响应。然后，控制器将要写入的数据字节发送到指定的寄存器。完成后，目标器件以一个响应位 (ACK) 进行响应。最后，控制器器件发送停止条件以完成单字节数据写入传输。

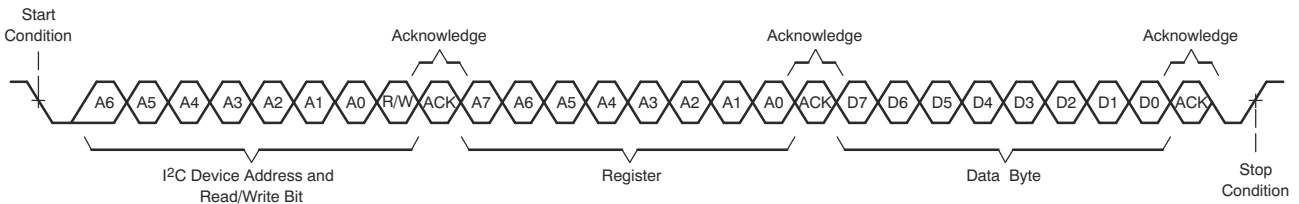


图 6-11. I²C 单字节写入传输

6.5.6 I²C 多字节写入

如图 6-12 所示，多字节数据写入传输与单字节数据写入传输完全相同，唯一的例外是控制器器件将多个数据字节传输到目标器件。收到每个数据字节之后，器件会用一个响应位 (ACK) 进行响应。最后，在完成最后一个数据字节传输后，控制器器件发送停止条件。

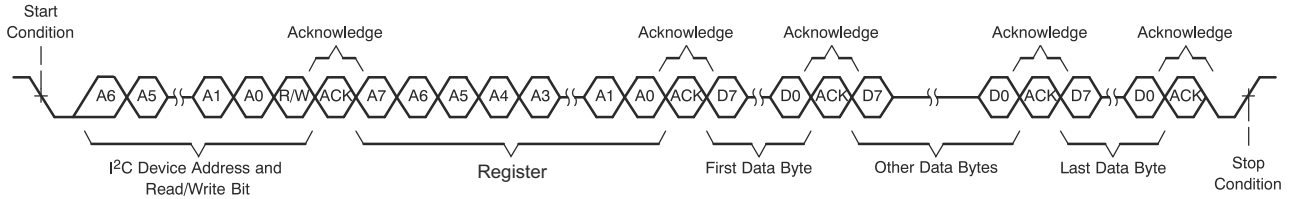


图 6-12. I²C 多字节写入传输

6.5.7 I²C 单字节读取

如图 6-13 所示，单字节数据读取传输始于控制器器件发送启动条件，后跟 I²C 目标地址和读取/写入位。对于数据读取传输，先后完成了写入和读取操作。最初，执行写入以传输要读取的内部寄存器地址的地址字节。因此，将读取/写入位设置为 0。

在接收到目标地址和读取/写入位后，器件会以一个响应位 (ACK) 进行响应。然后，控制器器件发送内部寄存器地址字节，之后器件发出一个响应位 (ACK)。控制器器件再次发送另一个启动条件，然后是目标地址和读取/写入位。这次，将读取/写入位设置为 1，指示读取传输。接下来，该器件从正在读取的寄存器地址传输数据字节。接收到数据字节后，控制器器件发送一个无应答 (NACK) 信号，然后是一个停止条件，以完成单字节数据读取传输。

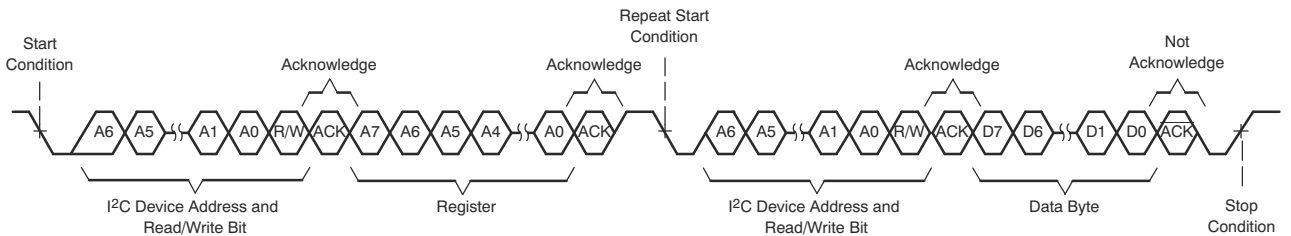


图 6-13. I²C 单字节读取传输

6.5.8 I²C 多字节读取

如图 6-14 所示，多字节数据读取传输与单字节数据读取传输完全相同，唯一的例外是器件将多个数据字节传输到控制器器件。除最后一个数据字节外，控制器器件在收到每个数据字节后都会用一个响应位进行响应。收到最后一个数据字节后，控制器器件发送一个无应答 (NACK) 信号，然后是一个停止条件，以完成数据读取传输。

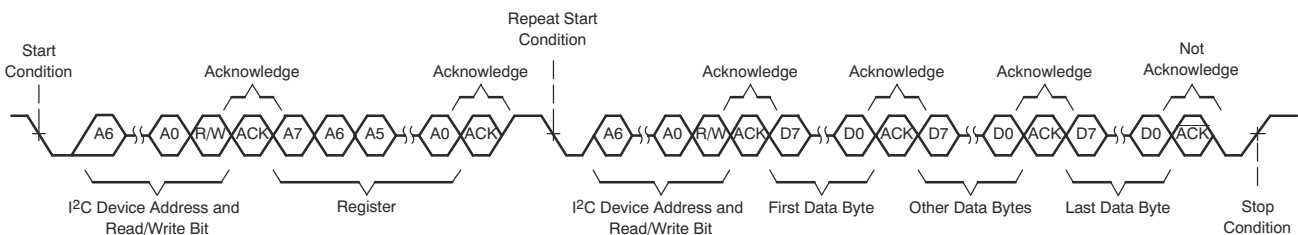


图 6-14. I²C 多字节读取传输

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定各元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现，以确保系统功能。

7.1 应用信息

TAS2120 是一款单通道数字输入 D 类放大器，具有集成式升压、电池电压和温度监测功能。I²S 音频数据与位时钟和帧同步信号一起由主机处理器通过 SDIN 数据端口提供。I²C 总线用于配置和控制。

器件需要由外部电源电压轨供电，即 VBAT : 2.5V 至 5.5V，VDD : 1.65V 至 1.95V，以及 IOVDD : 1.8V 或 3.3V。

建议使用 PurePath™ Console 3 (PPC3) 软件来配置器件，该工具可根据不同的应用场景优化器件性能参数。

7.2 典型应用

下图显示了 1S 和 2S 锂离子电池以及外部 PVDD 或 3S 电池连接的典型应用连接。VBAT_SNS 引脚连接是可选的，如果不使用，该引脚应接地。SEL1 用于选择器件的 HW 模式或 I²C 模式。

如果需要，系统可以使用相同的 1.8V 电源为 IOVDD 和 VDD 供电。去耦电容器 C2 和 C3 仍应靠近器件引脚放置。

VBAT、VDD、PVDD 电源轨对器件性能至关重要，应在源 PMIC 和这些引脚之间使用宽引线，以尽量减小寄生电感。对于这些电源轨，电源纹波应保持最小并应连接到公共电源平面。

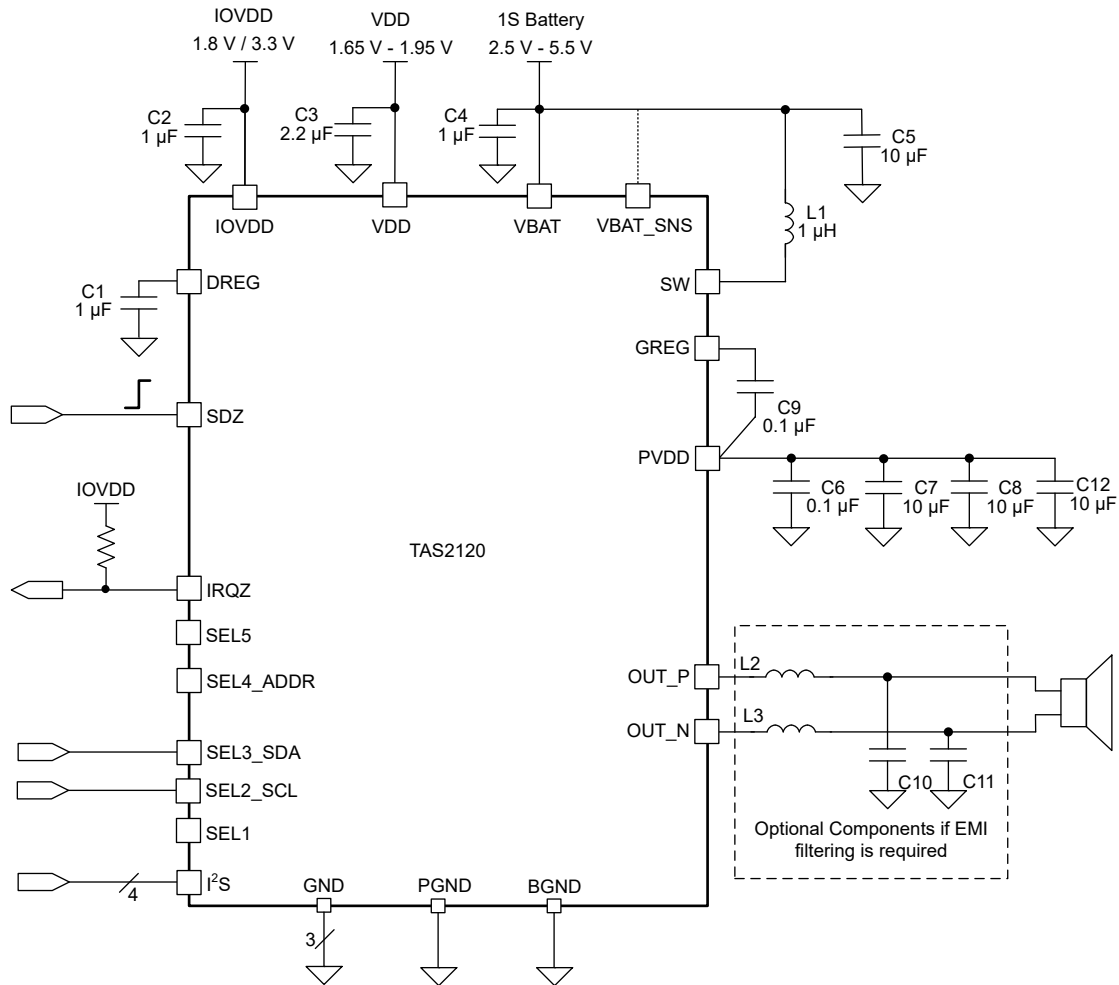


图 7-1. 1S 电池系统的应用示意图

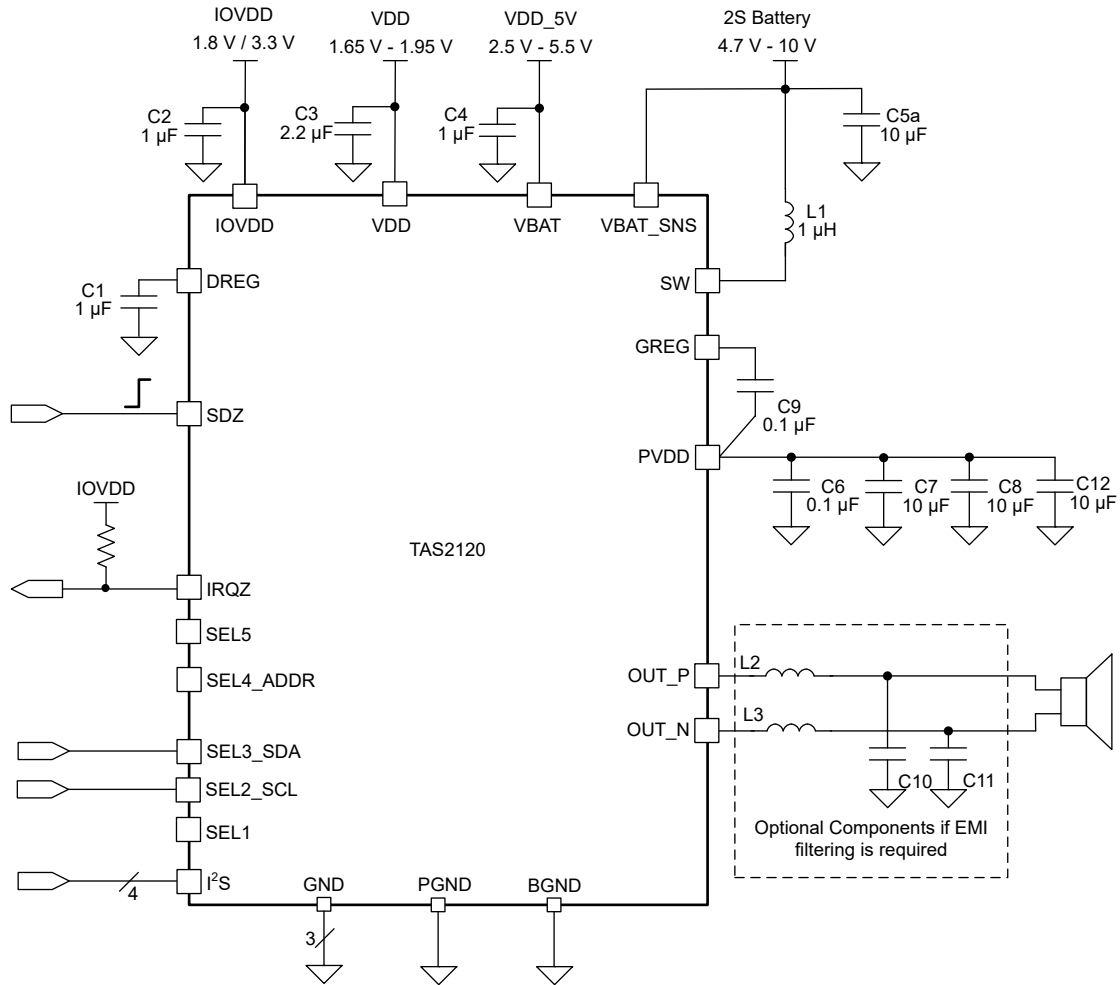


图 7-2. 2S 电池系统的应用示意图

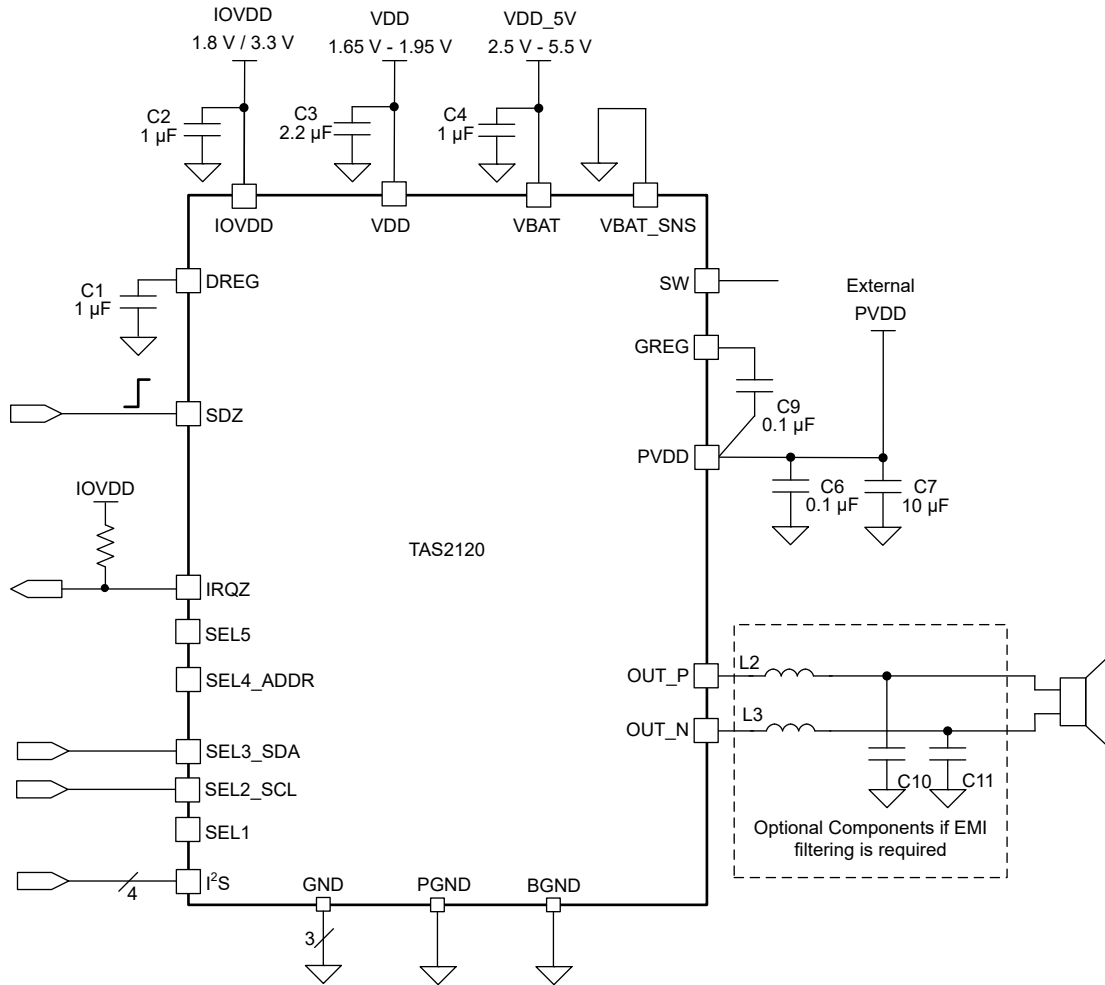


图 7-3. 外部 PVDD 或 3S 电池系统的应用示意图

ADVANCE INFORMATION

表 7-1. 推荐的外部元件

元件	说明	规格	最小值	典型值	最大值	单位
L1	升压转换器电感器	电感, 容差为 20%	0.47	1		μH
		饱和电流		5.3		A
L2、L3	可选的 EMI 滤波电感器 (如果使用 L2、L3, 则必须使用 C10、C11)	直流电流	2			A
C1, C2	DREG、IOVDD 去耦电容器	电容, 容差为 20%		1		μF
		电压额定值	2	6.3		V
C3	VDD 去耦电容器	电容, 容差为 20%		2.2		μF
		电压额定值	2	6.3		V
C4	VBAT 去耦电容器	电容, 容差为 20%		1		μF
		电压额定值	6.3	10		V
C5	1S 电池电源去耦电容器	电容, 容差为 20%		10		μF
		电压额定值	6.3	10		V
C5a	2S 电池电源去耦电容器	电容, 容差为 20%		10		μF
		电压额定值	10	16		V
C6	PVDD 低 ESL 去耦	电容, 容差为 20%		0.1		μF
		电压额定值	16	25		V
C7、C8、C12	PVDD 电源去耦电容器	电容, 容差为 20%		10		μF
		电压额定值	16	25		V
		1S 电池系统降额后 13V 直流电压下的有效总 PVDD 电容	3			μF
		2S 电池系统降额后 13V 直流电压下的有效总 PVDD 电容 注意: 2S 系统不需要 C12 就能满足降额规格。	2			μF
C9	GREG 去耦电容器	电容, 容差为 20%		0.1		μF
		电压额定值	6.3	10		V
C10、C11	可选的 EMI 滤波电容器 (如果使用 C10、C11, 则必须使用 L2、L3)	电压额定值	2xPVDD			V

7.2.1 设计要求

表 7-1 列出了应用所需的 BOM 元件。表 7-2 列出了应用的其他要求。

表 7-2. 设计参数

参数	条件	规格
VDD 电源电流 ⁽¹⁾	禁用 VDD Y 桥, 48ksps 模式, 启用所有块	< 15mA
	禁用 VDD Y 桥, 96ksps 模式, 启用所有块	< 20mA
IOVDD 电源电流	1.8V 模式	< 1mA
	3.3V 模式	< 1mA
VBAT 电源电流	1S 或 2S 运行模式。注意: 仅通过器件 VBAT 引脚的电流, 不包括通过升压电感器/SW 引脚获取的电池电流。	< 10mA

(1) 当启用 VDD Y 桥时, 会根据所选的切换阈值电压和输出负载阻抗从 VDD 电源获取额外的功率。

7.2.2 详细设计过程

(2)

7.2.2.1 单声道/立体声配置

在该应用中，假定器件在单声道模式下运行。有关更改 TAS2120 的 I²C 地址以支持立体声或多通道运行的信息，请参阅节 6.5.2。单声道或立体声配置不会影响器件性能。

7.2.2.2 升压转换器无源器件

升压转换器需要多个无源器件，这些器件在节 7.2 中标记为 L1、C7、C8、C12，表 7-1 提供了这些器件的规格。这些规格基于 TAS2120 的设计，是满足该器件性能目标所必需的。特别是，不应允许 L1 进入电流饱和区域。L1 的饱和电流 (I_{SAT}) 应大于 (ILIM + 5%) 才能提供 D 类峰值功率。应根据应用中所需的峰值输出功率选择 I_{SAT} 和 ILIM 值。

此外，L1/C (C7、C8、C12 的降额值) 比率必须小于 1/3 才能实现升压稳定性。在 2S 电池运行模式下，该比率放宽到 1/2。即使在升压电感器和输出电容器的最坏情况变化下，也应保持该比率。

为了满足足够的能量传输要求，L1 在升压开关频率 (100kHz 至 4MHz) 下需要 $\geq 0.47 \mu\text{H}$ 。使用 $0.47 \mu\text{H}$ 有助于降低电容器要求和节省布板空间，但代价是会增加 VBAT 上的电压纹波并降低平均输入电流，从而减小器件的最大 P_{OUT}。TAS2120 的高 PSRR 应更大程度地降低 VBAT 电源上额外纹波的影响。

L1 电感器串联电阻 (ESR) 是应用中选择另一个关键参数。较低的 ESR 可降低功率损耗并有助于提高整体系统效率。根据可用的布板空间，满足应用需求的最小 ESR 电感器将提供更好的效率性能。

7.2.2.3 EMI 无源器件

TAS2120 支持边沿速率控制，以更大限度地降低 EMI，但系统设计人员可能希望在 D 类输出端使用无源器件来进一步降低 EMI。这些无源器件在节 7.2 中标记为 L2、L3、C10 和 C11。如果使用 C10 和 C11，那么还必须安装 L2 和 L3，并且 C10 和 C11 必须分别放置在 L2 和 L3 之后，以保持输出级的稳定性。

EMI 滤波器的元件值选择取决于需要使用这些滤波器抑制的频带的应用需求。较高的截止频率有助于减少 BOM 并降低与滤波器相关的开关功率损耗。应用应选择符合系统频率抑制目标的最高截止频率滤波器，从而获得更好的效率性能。

EMI 滤波器中使用的电感器或铁氧体磁珠的直流电阻也对系统效率起着至关重要的作用。较低的电阻可降低功率损耗并有助于提高整体系统效率。根据可用的布板空间，满足应用需求的超小直流电阻元件将提供更好的效率性能。

7.2.2.4 各种无源器件

GREG 电容器需要 100nF 来满足升压与 D 类电力输送和效率规格。对于器件功能，GREG 电容器应通过开尔文/星形接法连接到器件的 PVDD 引脚。

为了保持器件性能并将电源纹波保持在器件规格范围内，需要尽可能地减小去耦电容器的电源/接地路径上的寄生电感。选择的所有电源去耦电容器应具有超小封装尺寸，从而尽可能减小电容器的 ESL。电容器的布局放置和布线对于更大限度地减小布线寄生电感至关重要。有关详细建议，请参阅“布局”部分 (节 9.1)。

7.2.3 应用性能曲线图

T_A = 25°C, VBAT = 3.6V, VDD = 1.8V, IOVDD = 1.8V, 负载 = 8 Ω + 33 μH, LBOOST = 1 μH, F_{IN} = 1kHz, F_s = 48kHz, 增益 = 21dBV, BST_ILIM = 5.1A, SDZ = 1, 禁用噪声门模式, 在 EVM 上使用典型应用用例 (节 7.2) 测得。测量时无滤波器, 通过 Audio Precision 使用 22Hz 至 20kHz 未加权带宽测得 (除非另有说明)。

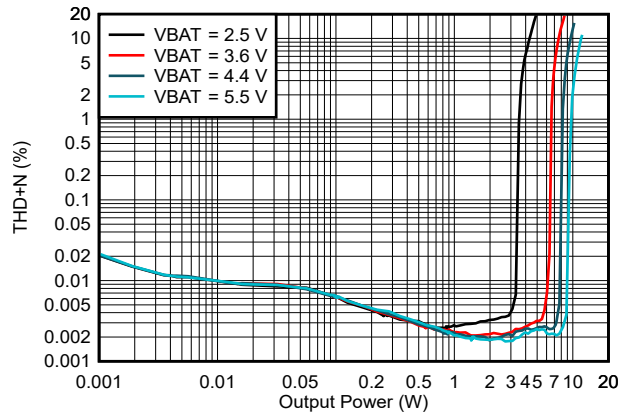


图 7-4. THDN 与输出功率间的关系

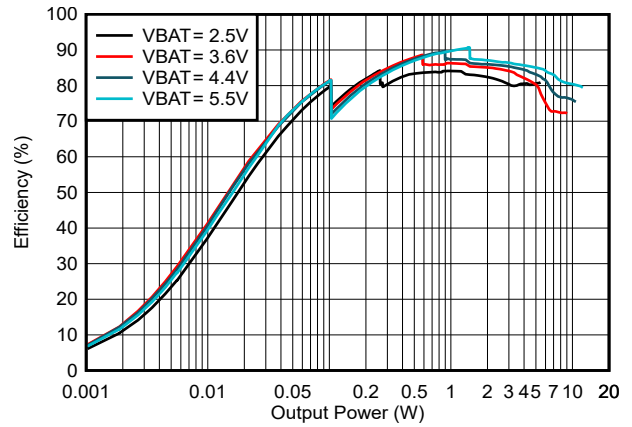


图 7-5. 效率与输出功率间的关系

8 电源相关建议

TAS2120 支持电源电压按照在 VDD、IOVDD、VBAT 和 PVDD 上外部提供的电压的任意序列顺序斜升/斜降 (用于外部 PVDD 模式)。

当电源不处于稳定工作状态时，SDZ 引脚必须保持低电平。一旦所有电源稳定，就可以将 SDZ 引脚置为高电平以使器件开始运行。在任何电源电压斜降至低于其建议工作电压之前，必须将 SDZ 引脚拉至低电平。

如果在外部 PVDD 模式下使用器件，则 SW 焊盘必须保持悬空。

一旦所有电源有效且 SDZ 引脚释放为高电平，数字内核电压稳压器就会上电，并启动内部初始化序列。硬件或软件复位后，对器件执行的附加 i2c 命令应延迟至少 300us，以允许初始化器件内部块。

9 布局

9.1 布局指南

- 针对承载大电流的信号使用宽引线，并尽可能避免使用过孔。如果无法避免使用过孔，则应添加多个过孔，以实现低寄生电感和高电流能力。这些包括用于 PVDD、VBAT、VDD、PGND、BGND、GND、OUT_P 和 OUT_N 的引线。
- PGND 和 BGND 信号应直接连接并短接到电路板的接地平面，从而更大限度地减小寄生电感。在连接到接地平面之前，应避免在接地引脚之间（例如 GND 和 PGND 或 GND 和 BGND 共模布线）产生共模电感。
- 敏感低压信号应避免在 OUT_P、OUT_N、SW 等高开关信号布线之间产生耦合。
- 尽可能地减小 OUT_P、OUT_N、SW 等高开关线路与接地/静态节点之间的电容。较大的电容会导致效率下降。OUT_P 和 OUT_N 之间的耦合也会导致效率降低。
- 至升压电感器和器件 VBAT 引脚的 VBAT 布线应以星形接法连接到公共 VBAT 电源平面。确保去耦电容器 C4 靠近器件放置，去耦电容器 C5 靠近电感器放置。
- 将升压电感器放置在 VBAT 和 SW 之间靠近器件端子的位置，器件端子和电感器之间没有过孔。VBAT 至升压电感器的布线应具有超低的布线电阻，以便器件发挥最佳性能。
- 去耦电容器应靠近器件放置。建议为去耦电容器使用尽可能小的封装尺寸，从而使器件发挥最佳性能。建议 DREG、VDD、IOVDD、VBAT（C4 电容器）、PVDD 低 ESL（C6 电容器）具有 0201 外壳尺寸或更小。应避免在去耦电容器和器件引脚之间使用过孔，或者也可以添加多个过孔来尽可能减小寄生电感。
- 所有去耦电容器的接地端子都应通过多个接地过孔牢固地连接到接地平面。应尽可能地减小电容器接地与器件接地引脚之间的接地布线环路。
- 对于 VDD Y 桥功能，从主机 PMIC 到器件 VDD 的布线应采用宽电源平面布线，并尽可能减小布线寄生电感。
- 对于 GREG-PVDD（C9 电容器）之间的电容器，电容器的 PVDD 侧不应直接连接到 PVDD 去耦电容器（C6、C7 和 C8），而应尽可能靠近器件 PVDD 引脚连接。
- 在外部 PVDD 运行模式下，SW 引脚应保持悬空，不连接到任何电源或接地信号。

9.2 布局示例

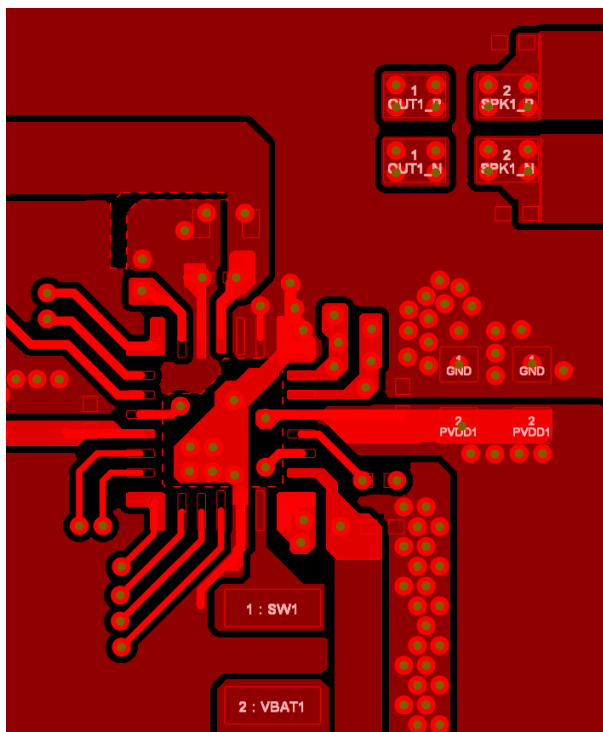


图 9-1. 示例布局顶部

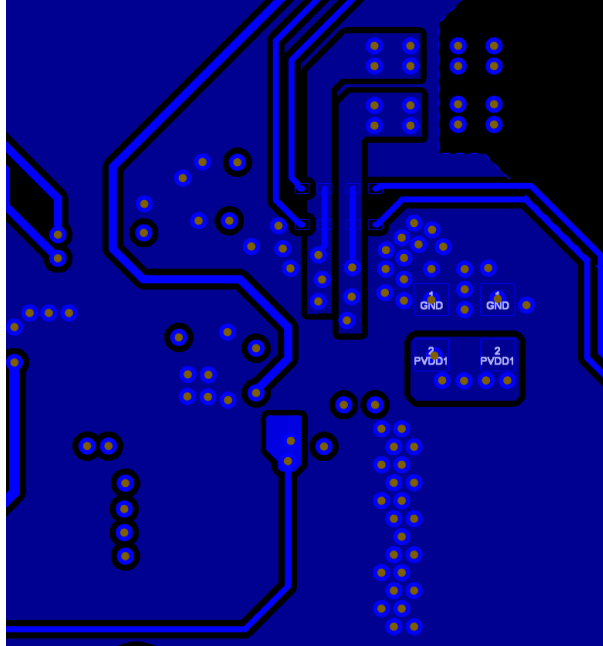


图 9-2. 示例布局底部

10 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

10.1 文档支持

10.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档

- 德州仪器 (TI), [PurePath Console 3 \(PPC3\) 软件](#)

10.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知, 请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册, 即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息, 请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

10.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料, 可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题, 获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范, 并且不一定反映 TI 的观点; 请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

10.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序, 可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级, 大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏, 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
2024 年 8 月	*	初始发行版

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

12.1 封装选项附录

封装信息

可订购器件	状态 ⁽¹⁾	封装类型	封装图	引脚	包装数量	环保计划 ⁽²⁾	铅/焊球镀层 ⁽⁶⁾	MSL 峰值温度 ⁽³⁾	工作温度 (°C)	器件标识 ^{(4) (5)}
PTAS2120RBGR	正在供货	VQFN-HR	RBG	26	3000	RoHS 和绿色 环保	NiPdAu	Level-1-260C- UNLIM	-40 至 85	PTS2X20

(1) 销售状态值定义如下：

正在供货：建议用于新设计的产品器件。

限期购买：TI 已宣布器件即将停产，但仍在购买期限内。

NRND：不推荐用于新设计。为支持现有客户，器件仍在生产，但 TI 不建议在新设计中使用此器件。

PRE_PROD：器件未发布，尚未量产，未向大众市场供货，也未在网络上供应，未提供样片。

预发布：器件已发布，但未量产。可能提供样片，也可能无法提供样片。

已停产：TI 已停止生产该器件。

(2) 环保计划 - 规划的环保分级包括：无铅 (RoHS)，无铅 (RoHS 豁免) 或绿色 (RoHS，无镉/溴) - 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情，请访问 www.ti.com.cn/productcontent。

待定：无铅/绿色环保转换计划尚未确定。

无铅 (RoHS)：TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求，包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求，因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。

无铅 (RoHS 豁免)：该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免：1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点；2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则，元件将根据上述规定视为无铅 (符合 RoHS)。

绿色环保 (RoHS，无镉/溴)：TI 定义的“绿色环保”表示无铅 (符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无镉 (Sb) 系阻燃剂 (均质材料中 Br 或 Sb 的质量不超过总质量的 0.1%)。

(3) MSL，峰值温度-- 湿敏等级额定值 (符合 JEDEC 工业标准分级) 和峰值焊接温度。

(4) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。

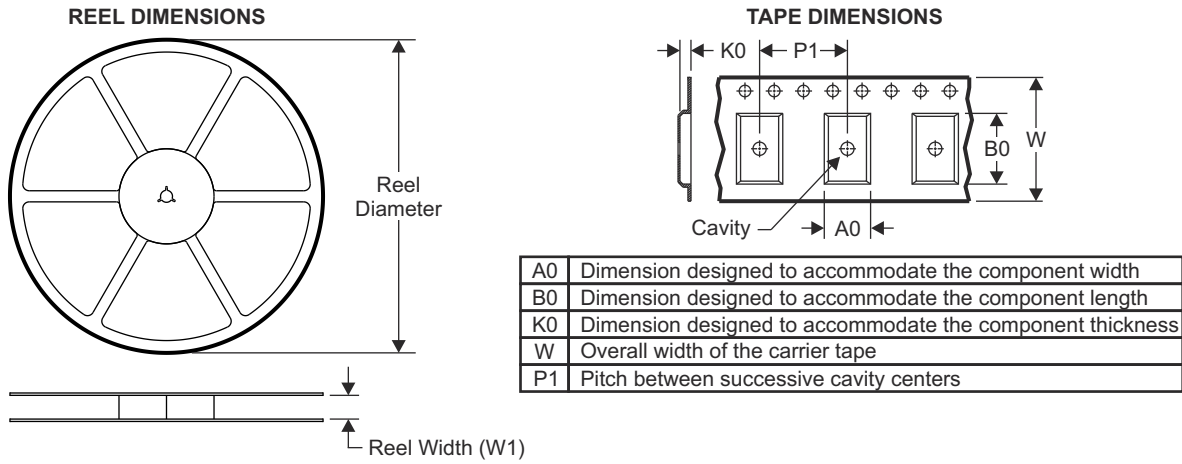
(5) 如有多个器件标识，将用括号括起来。不过，器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进，说明该行续接上一行，这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。

(6) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽，则会折为两行。

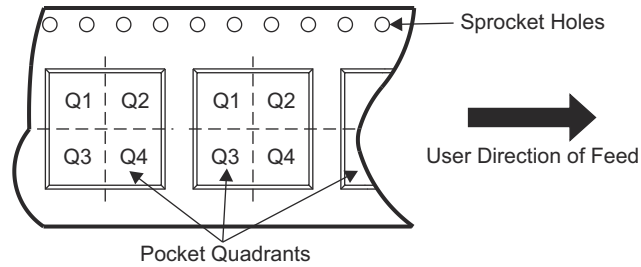
重要信息和免责声明：本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。

在任何情况下，TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。

12.2 卷带包装信息



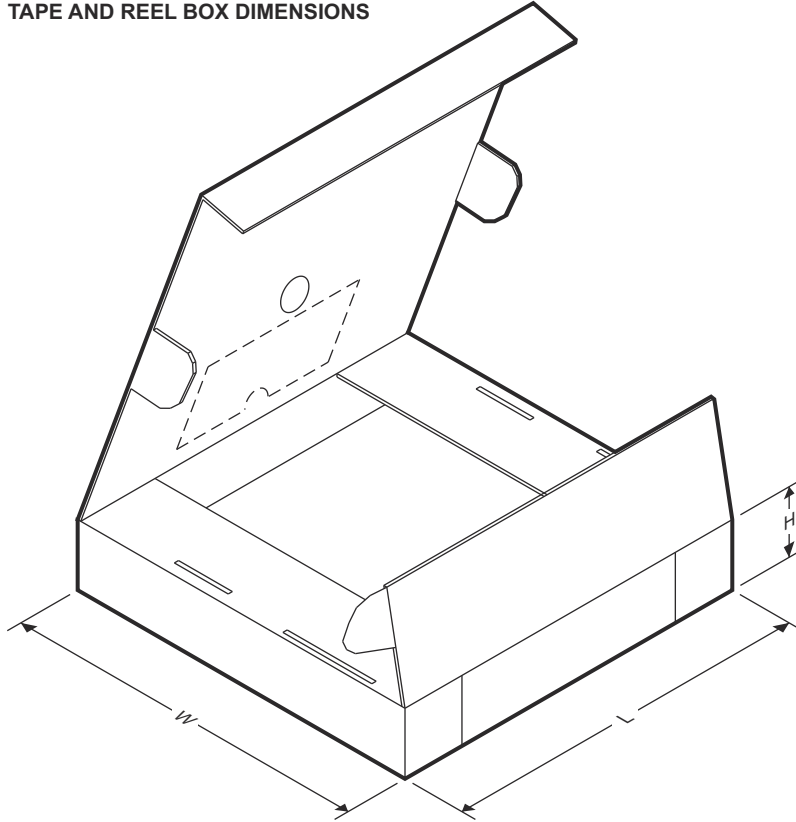
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
PTAS2120RBGR	VQFN-HR	RBG	26	3000	330	12.4	3.8	4.3	1.5	8	12	Q1

ADVANCE INFORMATION

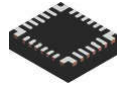
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
PTAS2120RBGR	VQFN-HR	RGB	26	3000	360.0	360.0	35

ADVANCE INFORMATION

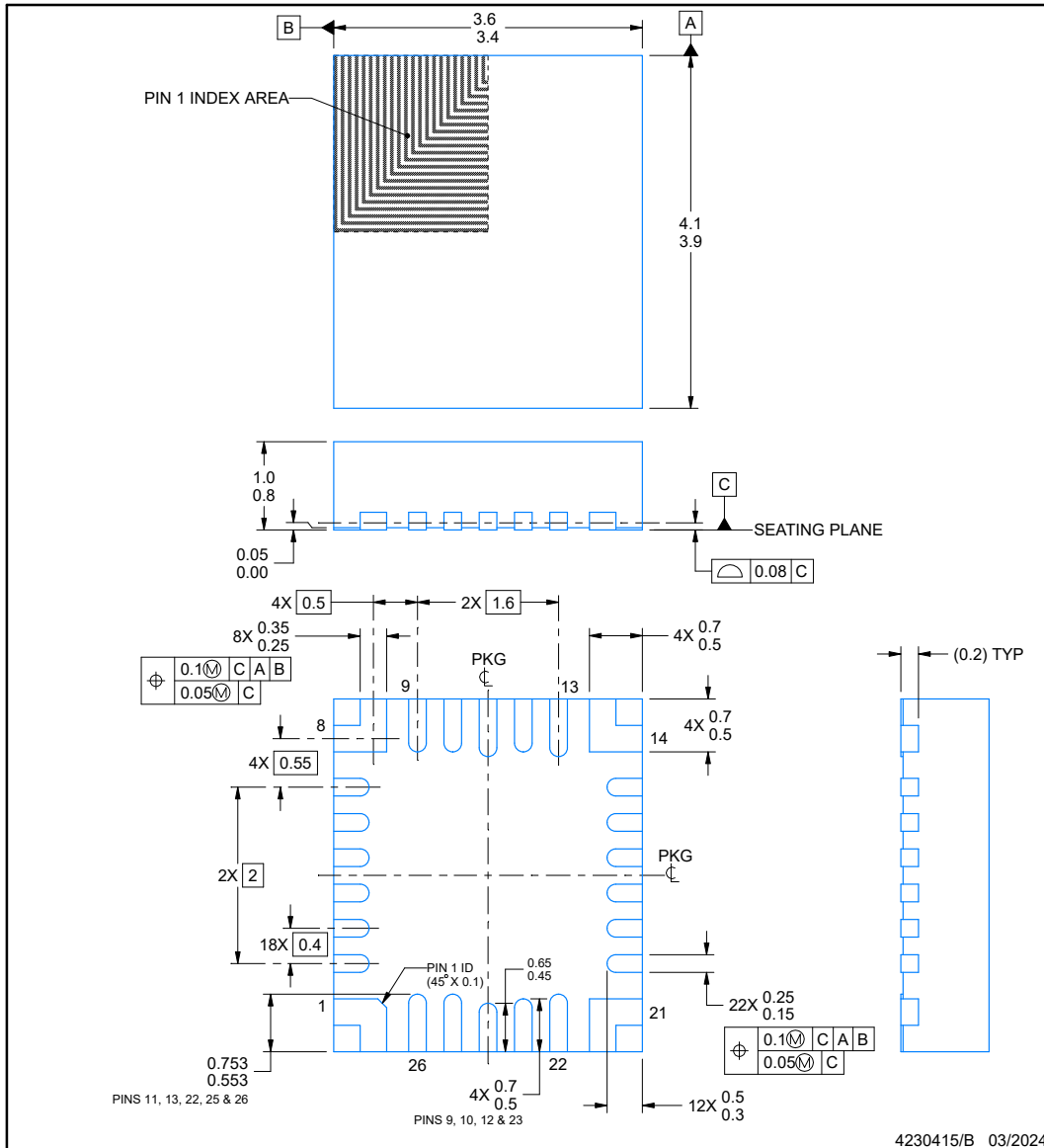
RBG0026A



PACKAGE OUTLINE
VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

ADVANCE INFORMATION



NOTES:

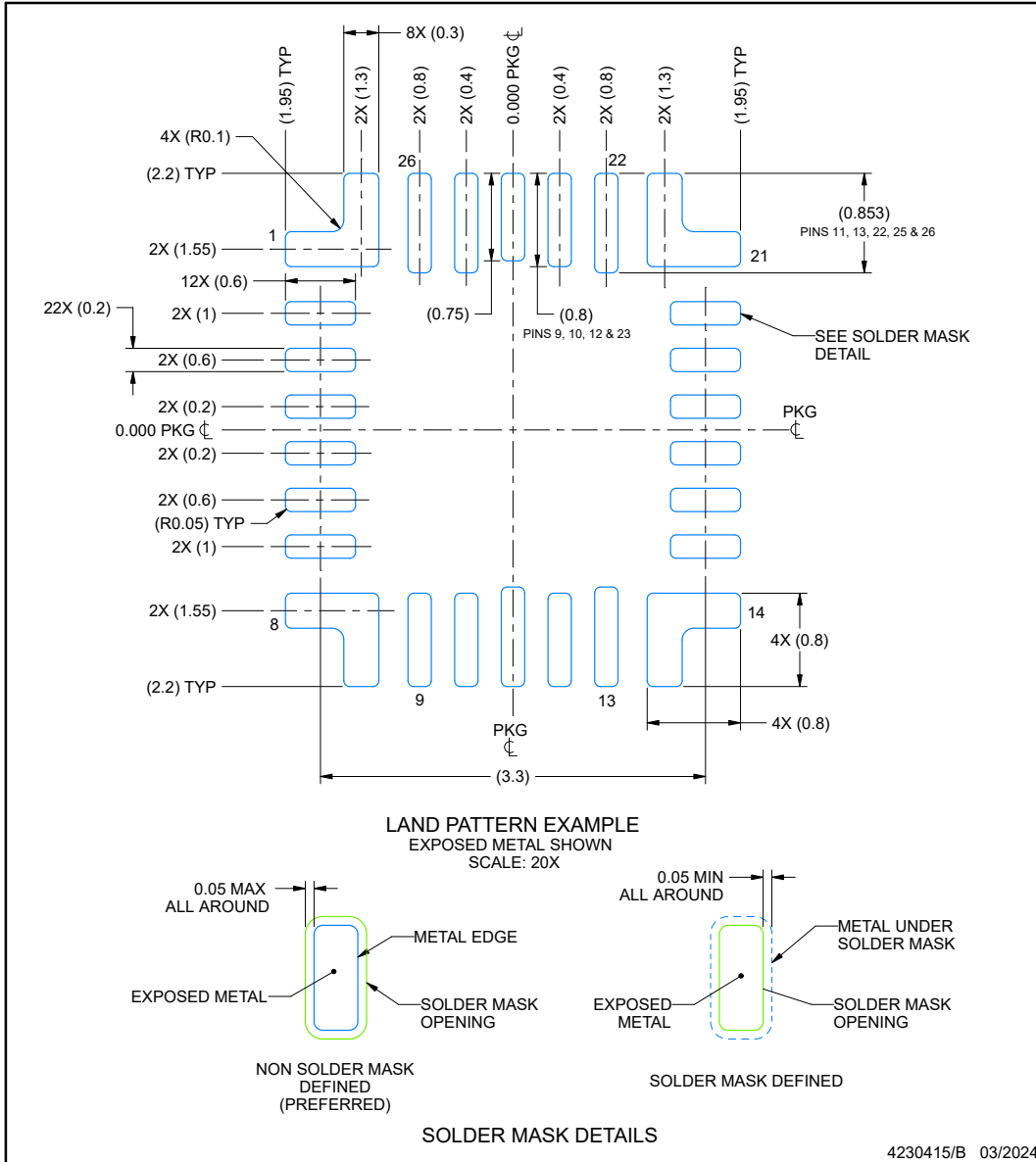
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

RBG0026A

VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).

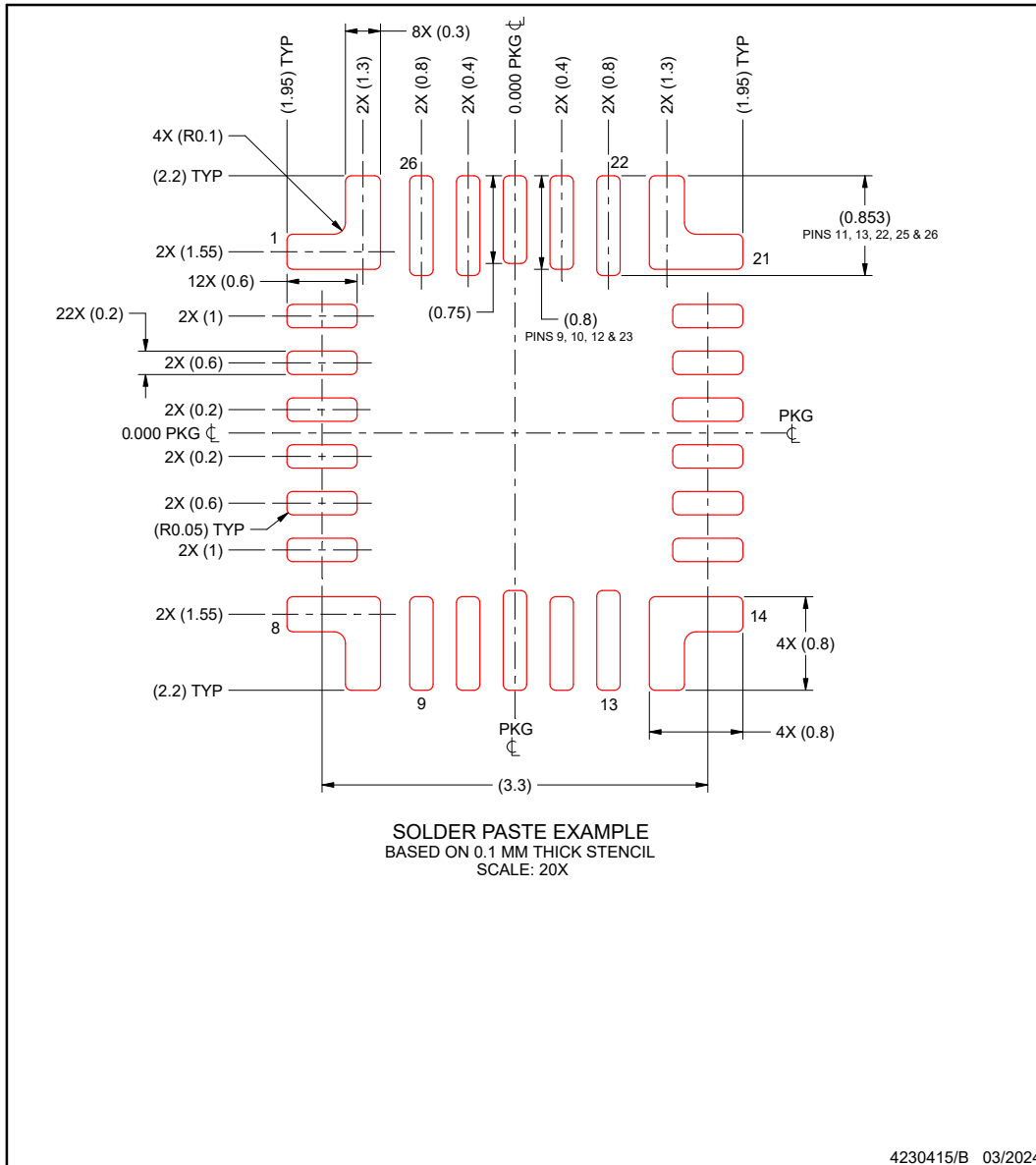
ADVANCE INFORMATION

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RBG0026A

VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
PTAS2120RBGR	ACTIVE	VQFN-HR	RBG	26	3000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85		Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

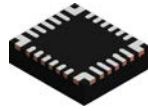
(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

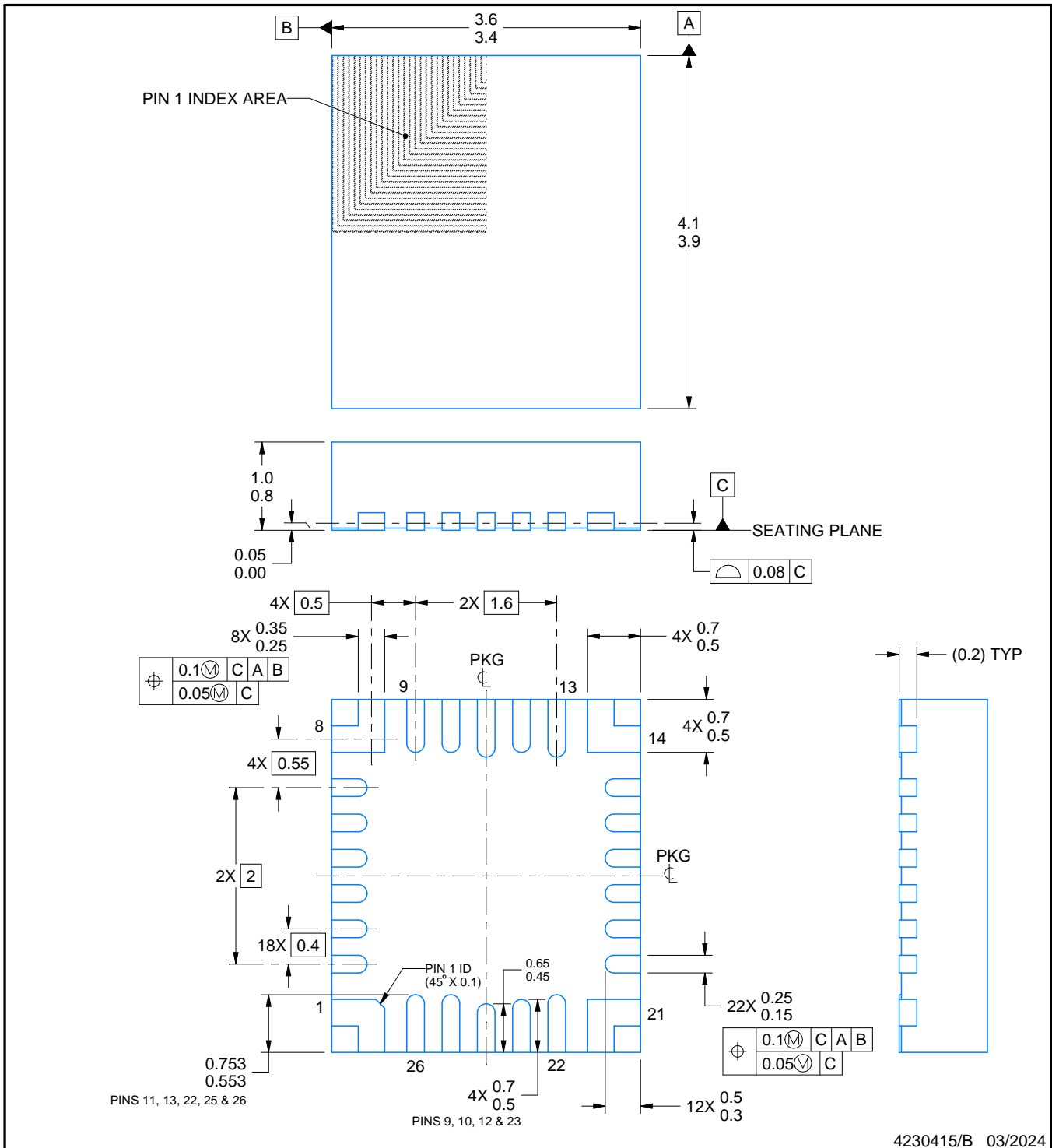
RBG0026A



PACKAGE OUTLINE

VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



4230415/B 03/2024

NOTES:

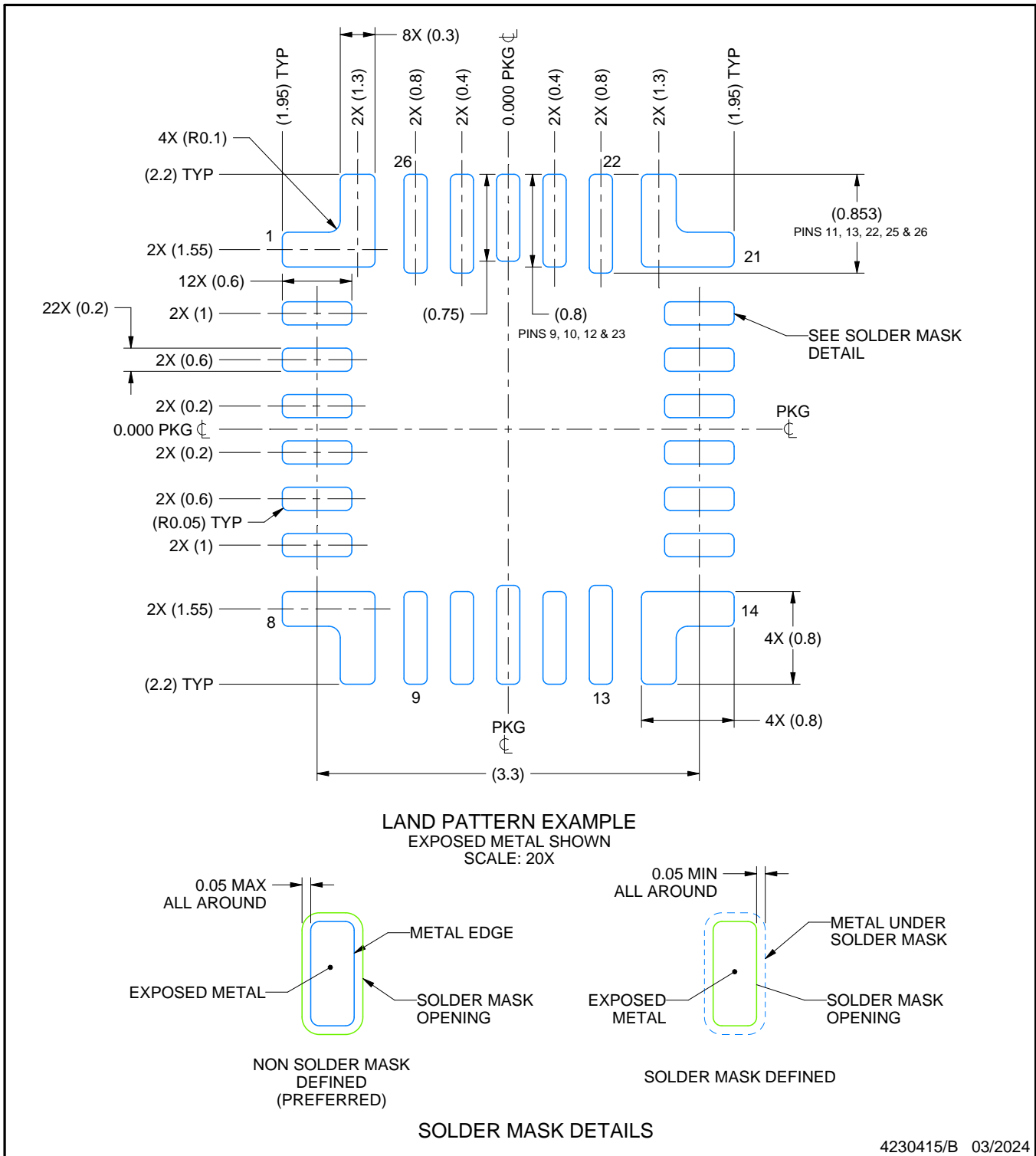
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

RBG0026A

VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



4230415/B 03/2024

NOTES: (continued)

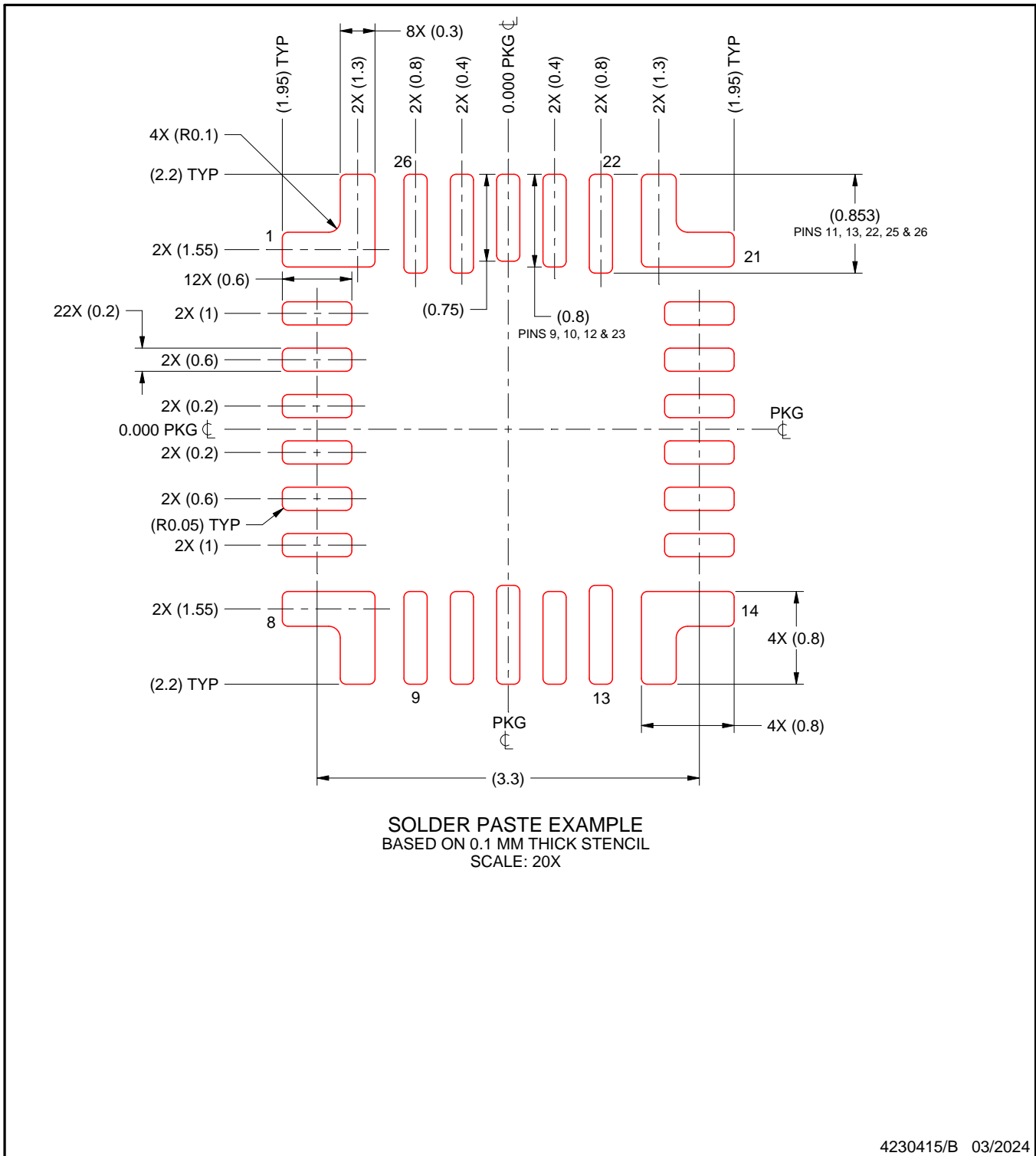
3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sl原因271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RBG0026A

VQFN-HR - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司